

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-194788

(43)Date of publication of application : 19.07.2001

(51)Int.Cl.

G03F 7/039
C08F220/10
C08F220/42
C08F230/08
C08K 5/42
C08L 33/04
C08L 43/04
G03F 7/004
G03F 7/075
H01L 21/027

(21)Application number : 2000-001895 (71)Applicant : FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing : 07.01.2000 (72)Inventor : SATO KENICHIRO

MIZUTANI KAZUYOSHI

(54) POSITIVE TYPE PHOTORESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive type photoresist composition which has an improved effect on a margin for exposure (particularly a margin for the exposure of isolated lines) in the production of a semiconductor device, that is, which is less liable to cause a change of the line width of isolated lines when light exposure is varied.

SOLUTION: The positive type photoresist composition contains (A) a sulfonic acid generating compound represented by a specified structure and (B) an acid decomposable resin containing at least specified silicon-containing repeating units or repeating units with a specified structure and having solubility to an alkali developing solution increased by the action of the acid.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-194788

(P2001-194788A)

(43)公開日 平成13年7月19日(2001.7.19)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード(参考)
G 0 3 F 7/039	6 0 1	G 0 3 F 7/039	6 0 1 2 H 0 2 5
C 0 8 F 220/10		C 0 8 F 220/10	4 J 0 0 2
220/42		220/42	4 J 1 0 0
230/08		230/08	
C 0 8 K 5/42		C 0 8 K 5/42	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全45頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-1895(P2000-1895)

(71)出願人 000005201

富士写真フィルム株式会社

神奈川県南足柄市中沼210番地

(22)出願日 平成12年1月7日(2000.1.7)

(72)発明者 佐藤 健一郎

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
真フィルム株式会社内

(72)発明者 水谷 一良

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
真フィルム株式会社内

(74)代理人 100105647

弁理士 小栗 昌平 (外6名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ポジ型フォトレジスト組成物

(57)【要約】

【課題】 半導体デバイスの製造において、露光マージン(特に孤立ラインの露光マージン)に対する改善効果がある、すなわち露光量を変化させたときの、孤立ラインの線幅変動が小さいポジ型フォトレジスト組成物を提供すること。

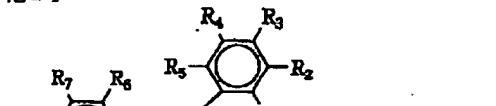
【解決手段】 (A)特定の構造で表されるスルホン酸を発生する化合物、(B)特定のシリコン含有繰り返し単位と、特定の構造の繰り返し単位のうち少なくともいずれかの繰り返し単位を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する酸分解性樹脂を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【特許請求の範囲】

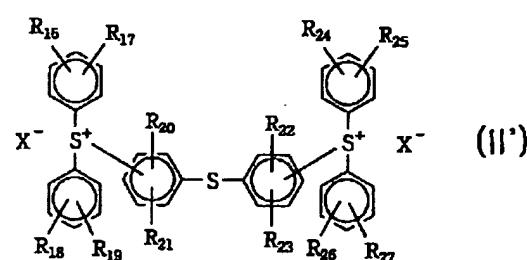
【請求項1】(A) 活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する下記一般式(I')～(III')で表される化合物のうち少なくとも1種

(B) 一般式(I)で表される繰り返し単位と、一般式(II)又は一般式(III)で表される繰り返し単位のうち少なくともいずれかの繰り返し単位を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

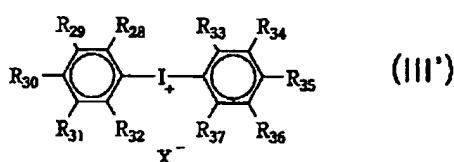
【化1】



(I')



(II')

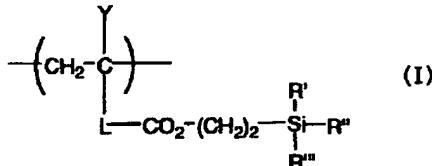


(III')

上記一般式(I')～(III')中: R₁～R₃₇は、同一又は異なって、水素原子、直鎖状、分岐状あるいは環状ア

ルキル基、直鎖状、分岐状あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、又は-S-R₃₈基を表す。R₃₈は、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基又はアリール基を表す。また、R₁～R₁₅、R₁₆～R₂₇、R₂₈～R₃₇のうち、2つ以上が結合して、単結合、炭素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環を形成してもよい。X⁻は、R^FSO₃⁻を表す。ここでR^Fは、炭素数2以上のフッ素置換された直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基である。

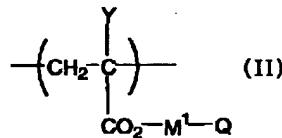
10 【化2】



(I)

一般式(I)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又は塩素原子を表す。Lは単結合または2価の連続基を表す。R'、R''及びR'''はそれぞれ独立に直鎖もしくは分岐のアルキル基、フェニル基、トリアルキルシリル基またはトリアルキルシリルオキシ基を表す。

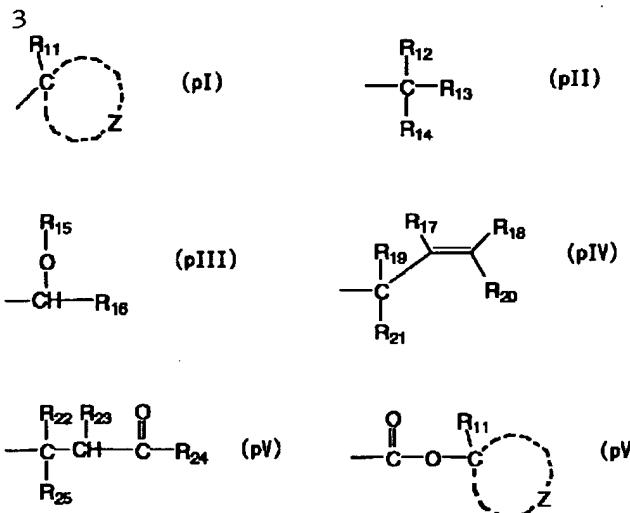
【化3】



(II)

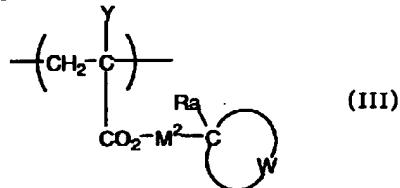
式(II)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基または塩素原子を表す。M¹は単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連続基を表す。Qは下記一般式(pI)～(pV)で表される脂環式炭化水素構造を含む基を表す。

【化4】



一般式 (p I) ~ (p VI) 中、R₁₁は、メチル基、エチル基、n-ブロピル基、イソブロピル基、n-ブチル基、イソブチル基またはsec-ブチル基を表し、Zは、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するのに必要な原子団を表す。R₁₂~R₁₆は、各々独立に、炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基または脂環式炭化水素基を表し、但し、R₁₂~R₁₄のうち少なくとも1つ、あるいはR₁₅及びR₁₆のうちの少なくともいずれか一方は脂環式炭化水素基を表す。R₁₇~R₂₁は、各々独立に、水素原子、炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。但し、R₁₇~R₂₁のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、R₁₉及びR₂₁のうちの少なくともいずれか一方は炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。R₂₂~R₂₅は、各々独立に、炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。但し、R₂₂~R₂₅のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【化5】



一般式(III)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又は塩素原子を表す。M²は、単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、橋かけ構造を有していてもよいシクロアルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エスチル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。Raは、水素原子、または置換基を有していてもよい、直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。Wは、結合する炭素原子と共にラクトン構造を *50

*形成するのに必要な原子群を表す。

【請求項2】 X-のR^YがCF₃(CF₂)_y (ここで、yは1~15の整数である)で示されるフッ素置換直鎖状アルキル基であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】 yが3~13の整数であることを特徴とする請求項2に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項4】 yが7~11の整数であることを特徴とする請求項3に記載のポジ型レジスト組成物。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体集積回路素子、集積回路製造用マスク、プリント配線板、液晶パネル等の製造に用いるポジ型フォトレジスト組成物に関する。

【0002】

【従来の技術】半導体素子、磁気バブルメモリ、集積回路等の電子部品を製造するためのパターン形成法としては、従来より、紫外線又は可視光線に感光するフォトレジストを利用する方法が幅広く実用に供されている。フォトレジストには、光照射により被照射部が現像液に不溶化するネガ型と、反対に可溶化するポジ型とがあるが、ネガ型はポジ型に比べて感度が良く、湿式エッチングに必要な基板との接着性及び耐薬品性にも優れていることから、近年までフォトレジストの主流を占めていた。

【0003】しかし、半導体素子等の高密度化・高集積化に伴い、パターンの線幅や間隔が極めて小さくなり、また、基板のエッチングにはドライエッチングが採用されるようになったことから、フォトレジストには高解像度及び高ドライエッティング耐性が望まれるようになり、現在ではポジ型フォトレジストが大部分を占めるようになった。特に、ポジ型フォトレジストの中でも、感度、解像度、ドライエッティング耐性に優れることから、例えばジェー・シー・ストリエータ著、コダック・マイクロ

エレクトロニクス・セミナー・プロシーディングス、第116頁(1976年)(J.C. Strieter, Kodak Microelectronics Seminar Proceedings, 116 (1976年)等に記載されているアルカリ可溶性のノボラック樹脂をベースにしたアルカリ現像型のポジ型フォトレジストが現行プロセスの主流となっている。

【0004】しかしながら、近年電子機器の多機能化、高度化に伴ない、さらに高密度化及び高集積化を図るべくパターンの微細化が強く要請されている。即ち、集積回路の横方向の寸法の縮小に比べてその縦方向の寸法はあまり縮小されていかないために、レジストパターンの幅に対する高さの比は大きくならざるを得なかった。このため、複雑な段差構造を有するウエハー上でレジストパターンの寸法変化を押さえていくことは、パターンの微細化が進むにつれてより困難になってきた。さらに、各種の露光方式においても、最小寸法の縮小に伴ない問題が生じてきている。例えば、光による露光では、基板の段差に基づく反射光の干渉作用が、寸法精度に大きな影響を与えるようになり、一方電子ビーム露光においては、電子の後方散乱によって生ずる近接効果により、微細なレジストパターンの高さと幅の比を大きくすることができなくなってしまった。

【0005】これらの多くの問題は多層レジストシステムを用いることにより解消されることが見出された。多層レジストシステムについては、ソリッドステート・テクノロジー、74 (1981) [Solid State Technology, 74 (1981)] に概説が掲載されているが、この他にもこのシステムに関する多くの研究が発表されている。一般的に多層レジスト法には3層レジスト法と2層レジスト法がある。3層レジスト法は、段差基板上有機平坦化膜を塗布し、その上に、無機中間層、レジストを重ね、レジストをバーニングした後、これをマスクとして無機中間層をドライエッティングし、さらに、無機中間層をマスクとして有機平坦化膜をO₂ RIE (リアクティブイオンエッティング)によりバーニングする方法である。この方法は、基本的には、従来からの技術が使用できるために、早くから検討が開始されたが、工程が非常に複雑である、あるいは有機膜、無機膜、有機膜と三層物性の異なるものが重なるために中間層にクラックやピンホールが発生しやすいといったことが問題点になっている。

【0006】この3層レジスト法に対して、2層レジスト法では、3層レジスト法でのレジストと無機中間層の両方の性質を兼ね備えたレジスト、すなわち、酸素プラズマ耐性のあるレジストを用いるために、クラックやピンホールの発生が抑えられ、また、3層から2層になるので工程が簡略化される。しかし、3層レジスト法では、上層レジストに従来のレジストが使用できるのに対して、2層レジスト法では、新たに酸素プラズマ耐性のあるレジストを開発しなければならないという課題がある。

った。

【0007】以上の背景から、2層レジスト法等の上層レジストとして使用できる酸素プラズマ耐性に優れた、高感度、高解像度のポジ型フォトレジスト、特に、現行プロセスを変えることなく使用できるアルカリ現像方式のレジストの開発が望まれていた。

【0008】さらに、ハーフミクロン以下の線幅からなる超微細パターンの加工が必要な超LSIの製造等においては、リソグラフィーに用いられる露光装置の使用波長の短波化が進行し、今やKrFエキシマーレーザー光、ArFエキシマーレーザー光を用いる事が検討されるまでになってきている。この様な短波長の光リソグラフィーでは、レジストは化学增幅型と呼ばれるものを用いるのが一般的である。なかでもArFエキシマーレーザー光を利用する場合は、膜の光学的透明性の観点からレジストの主成分となるバインダー樹脂中にフェノール構造を導入する事は適当ではなく、t-ブチルエステル等の3級エステル、1-アルキルアダマンチルエステル、カルボン酸のTHP保護体など、酸で分解してカルボン酸を発生する構造を画像形成性部位として含有する樹脂ポリマーをバインダーとして用いるのが一般的である。ArFエキシマーレーザー光に透明な画像形成性部位を含有するSi含有ポリマーは、例えば特開平8-160623号、特開平10-324748号、特開平11-60733号、特開平11-60734号に開示されている。

【0009】SPIE、第3678巻、241項には、酸分解性エステル末端にトリス(トリメチルシリル)シリルエチル基を含有するビニルポリマーを用いた化学增幅型レジストが開示されている。また、SPIE、第3678巻、214項及び562項には、酸分解性エステル末端にトリメチルルービス(トリメチルシリル)ジシラヘアチルメチルプロピルエステルを含有するビニルポリマーを用いた化学增幅型レジストが開示されている。しかしながら、これらの技術でも露光マージンにおいて問題点が存在した。ここで露光マージンとは、露光量が変化すると、それに従って得られるパターンの線幅が変化してしまう現象をいう。

【0010】
40 【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、半導体デバイスの製造において、露光マージン(特に孤立ラインの露光マージン)に対する改善効果がある、すなわち露光量を変化させたときの、孤立ラインの線幅変動が小さいポジ型フォトレジスト組成物を提供することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、ポジ型化学增幅系におけるレジスト組成物について鋭意検討した結果、(A)特定構造の光酸発生剤、(B)特定の繰り返し単位を共重合した酸分解性樹脂を用いることによ

り、本発明の目的が達せられることを見出した。即ち、上記目的は、下記構成を有するポジ型フォトレジスト組成物を用いることにより達成される。

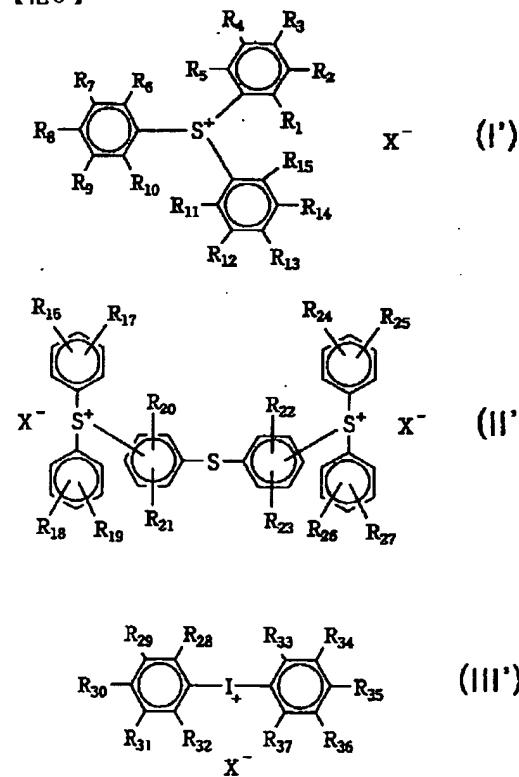
【0012】(1) (A) 活性光線又は放射線の照射によりスルホン酸を発生する下記一般式(I')～(II)

I')で表される化合物のうち少なくとも1種

(B) 一般式(I)で表される繰り返し単位と、一般式(II)又は一般式(III)で表される繰り返し単位のうち少なくともいずれかの繰り返し単位を含有し、酸の作用によりアルカリ現像液に対する溶解度が増大する樹脂を含有することを特徴とするポジ型フォトレジスト組成物。

【0013】

【化6】

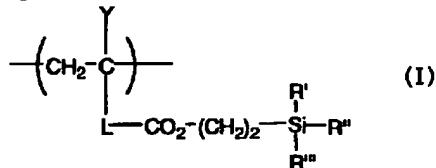


【0014】上記一般式(I')～(III')中：R₁～R₃₇は、同一又は異なって、水素原子、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基、直鎖状、分岐状あるいは環状アルコキシ基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、又は-S

-R₃₈基を表す。R₃₈は、直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基又はアリール基を表す。また、R₁～R₁₅、R₁₆～R₂₇、R₂₈～R₃₇のうち、2つ以上が結合して、単結合、炭素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環を形成してもよい。X⁻は、R^FSO₃⁻を表す。ここでR^Fは、炭素数2以上のフッ素置換された直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基である。

【0015】

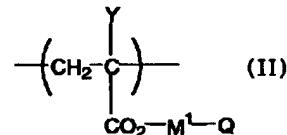
【化7】



【0016】一般式(I)中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又は塩素原子を表す。Lは単結合または2価の連結基を表す。R'、R''及びR'''はそれぞれ独立に直鎖もしくは分岐のアルキル基、フェニル基、トリアルキルシリル基またはトリアルキルシリルオキシ基を表す。

【0017】

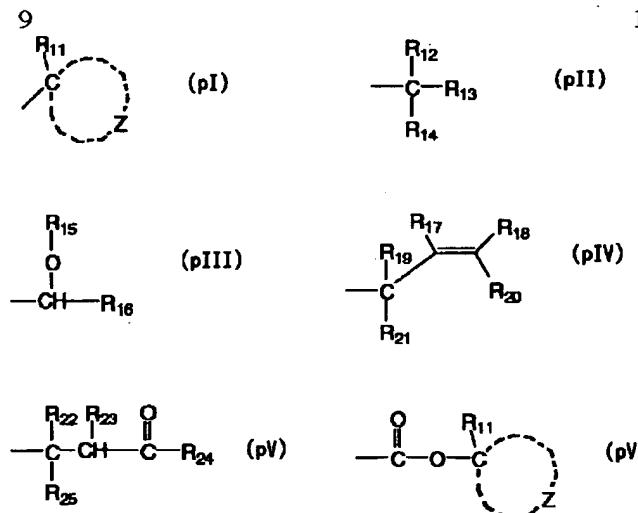
【化8】



【0018】式(II)中、Yは水素原子、メチル基、シアン基または塩素原子を表す。M¹は単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。Qは下記一般式(pI)～(pVI)で表される脂環式炭化水素構造を含む基を表す。

【0019】

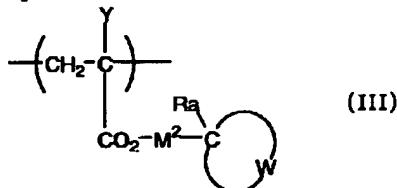
【化9】



【0020】一般式 (pI) ~ (pVI) 中、R₁₁は、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基またはsec-ブチル基を表し、Zは、炭素原子とともに脂環式炭化水素基を形成するに必要な原子団を表す。R₁₂~R₁₆は、各々独立に、炭素数1~4個の、直鎖もしくは分岐のアルキル基または脂環式炭化水素基を表し、但し、R₁₂~R₁₄のうち少なくとも1つ、あるいはR₁₅及びR₁₆のうちの少なくともいづれか一方は脂環式炭化水素基を表す。R₁₇~R₂₁は、各々独立に、水素原子、炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。但し、R₁₇~R₂₁のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。また、R₁₉及びR₂₁のうちの少なくともいづれか一方は炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。R₂₂~R₂₅は、各々独立に、炭素数1~4個の直鎖もしくは分岐のアルキル基、または脂環式炭化水素基を表す。但し、R₂₂~R₂₅のうち少なくとも1つは脂環式炭化水素基を表す。

【0021】

【化10】



【0022】一般式(III) 中、Yは水素原子、メチル基、シアノ基又は塩素原子を表す。M²は、単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、橋かけ構造を有していてもよいシクロアルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。Raは、水素原

*子、または置換基を有していてもよい、直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。Wは、結合する炭素原子と共にラクトン構造を形成するに必要な原子群を表す。

【0023】(2) X²のR²がC₂F₃(CF₂)_y (ここで、yは1~15の整数である)で示されるフッ素置換直鎖状アルキル基であることを特徴とする前記(1)に記載のポジ型レジスト組成物。

(3) yが3~13の整数であることを特徴とする前記(2)に記載のポジ型レジスト組成物。
(4) yが7~11の整数であることを特徴とする前記(3)に記載のポジ型レジスト組成物。

【0024】

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物について詳細に説明する。

30 (A) 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物(光酸発生剤)
本発明では、光酸発生剤として、上記一般式(I')~(III')で表される化合物の少なくとも1種が用いられる。一般式(I')~(III')において、R₁~R₃₈の直鎖状、分岐状アルキル基としては、置換基を有してもよい、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。環状アルキル基としては、置換基を有してもよい、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基のような炭素数3~8個のものが挙げられる。

40 R₁~R₃₇の直鎖状、分岐状アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、n-ブトキシ基、イソブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。

【0025】環状アルコキシ基としては、シクロペンチルオキシ基、例えば、シクロペンチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基が挙げられる。R₁~R₃₇のハロゲン原子としては、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、溴素原子を挙げることができる。R₃₈のアリール基として

11

は、例えば、フェニル基、トリル基、メトキシフェニル基、ナフチル基のような置換基を有してもよい炭素数6～14個のものが挙げられる。これらの置換基として好ましくは、炭素数1～4個のアルコキシ基、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、溴素原子）、炭素数6～10個のアリール基、炭素数2～6個のアルケニル基、シアノ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

【0026】また、R₁～R₁₅、R₁₆～R₂₇、R₂₈～R₃₁のうち、2つ以上が結合して形成する、単結合、炭素、酸素、イオウ、及び窒素から選択される1種又は2種以上を含む環としては、例えば、フラン環、ジヒドロフラン環、ビラン環、トリヒドロビラン環、チオフェン環、ピロール環等を挙げることができる。

【0027】一般式(I')～(III')において、X⁻は、R^FSO₃⁻で表されるアニオンである。ここでR^Fは、炭素数が2以上、好ましくは炭素数2～10、より好ましくは炭素数2～8、より好ましくは炭素数2～5のフッ素置換された直鎖状、分岐状あるいは環状アルキル基である。好ましいR^Fとしては、CF₃(CF₂)_yで表され、yが1～15の整数であるフッ素置換直鎖状アルキル基であり、より好ましくはyが3～13の整数、さらに好ましくはyが7～11の整数のフッ素置換直鎖状アルキル基[CF₃(CF₂)_y]を用いることにより、感度、解像力のバランスに優れ、また露光から後加熱までの経時によっても性能変化が小さくなる。R^Fとしては、具体的には、CF₃CF₂⁻、CF₃(CF₂)₂⁻、CF₃(C

12

F₂)₃⁻、CF₃(CF₂)₄⁻、CF₃(CF₂)₅⁻、CF₃(CF₂)₇⁻、CF₃(CF₂)₉⁻、CF₃(CF₂)₁₁⁻、CF₃(CF₂)₁₃⁻、CF₃(CF₂)₁₅⁻であり、好ましくはCF₃(CF₂)₃⁻、CF₃(CF₂)₄⁻、CF₃(CF₂)₅⁻、CF₃(CF₂)₇⁻、CF₃(CF₂)₉⁻、CF₃(CF₂)₁₁⁻、CF₃(CF₂)₁₃⁻であり、更に好ましくはCF₃(CF₂)₇⁻、CF₃(CF₂)₉⁻、CF₃(CF₂)₁₁⁻である。特に好ましくはCF₃(CF₂)₇⁻である。

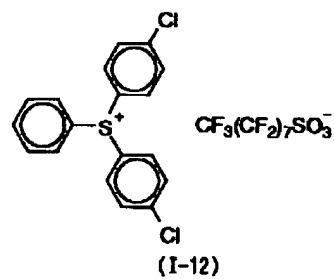
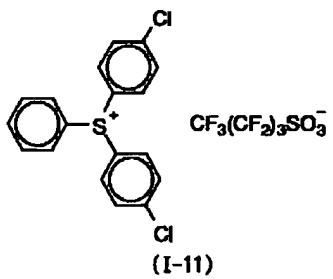
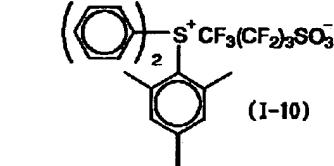
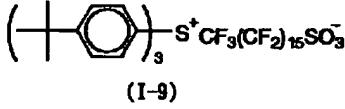
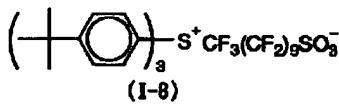
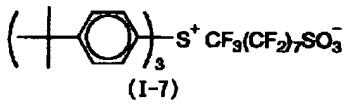
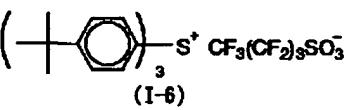
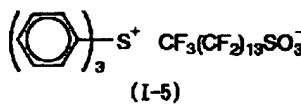
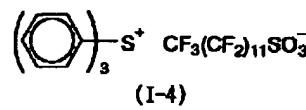
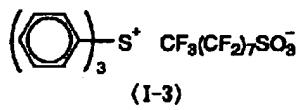
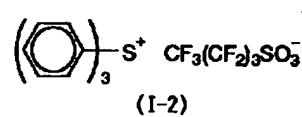
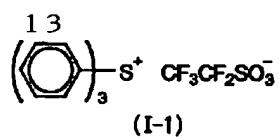
10 10 【0028】特に好ましい光酸発生剤は、一般式(I')で表され、かつX⁻がCF₃(CF₂)₃SO₃⁻である化合物である。

【0029】このようなアニオン部がフッ素置換されたアルキル基を有するスルホン酸アニオンで構成されている一般式(I')～(III')で表される化合物を光酸発生剤として用い、かつ前記特定構造の樹脂成分(A)と組み合わせることにより、本発明のポジ型レジスト組成物は、遠紫外光、とくにArFエキシマレーザー光（波長193nm）の露光に対する十分な感度及び解像力を有し、しかも露光後の経時に対して優れたパターンプロファイル及び解像力を維持する。

【0030】一般式(I')～(III')で表される光酸発生剤の具体例として、下記の化合物(I-1)～(I-32)、(II-1)～(II-11)、(III-1)～(III-22)を挙げることができる。

【0031】

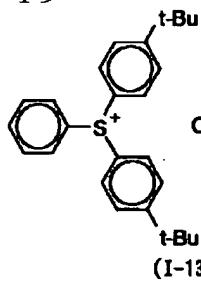
【化11】



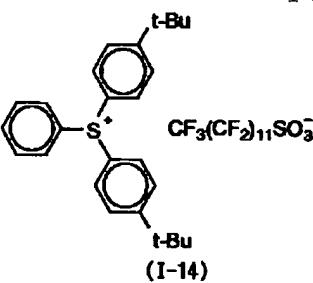
【0032】

* * 【化12】

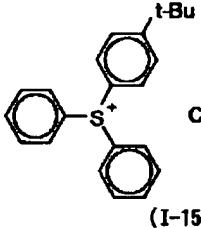
15



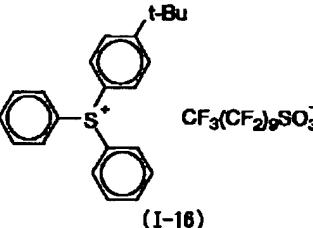
(I-13)



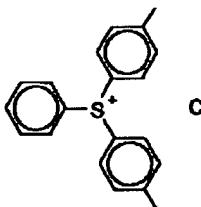
(I-14)



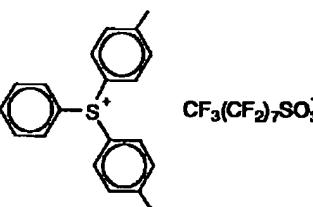
(I-15)



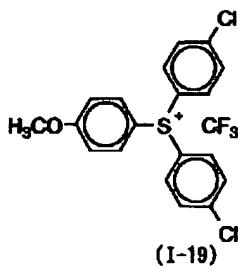
(I-16)



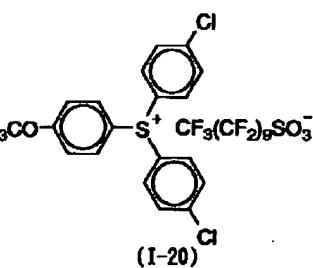
(I-17)



(I-18)



(I-19)



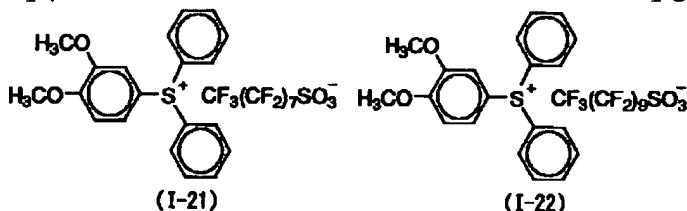
(I-20)

16

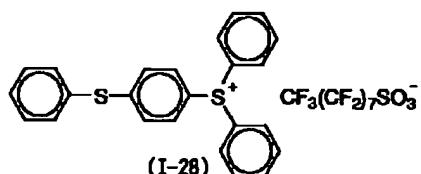
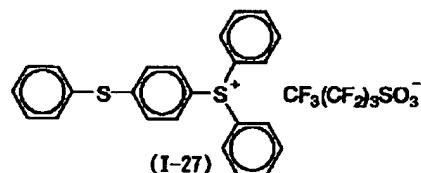
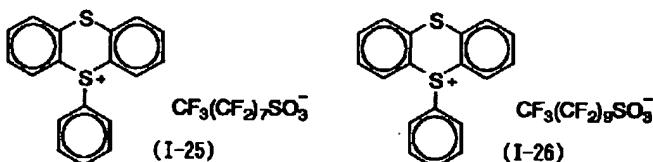
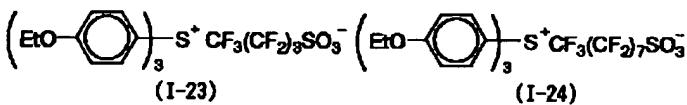
【0033】

* * 【化13】

17

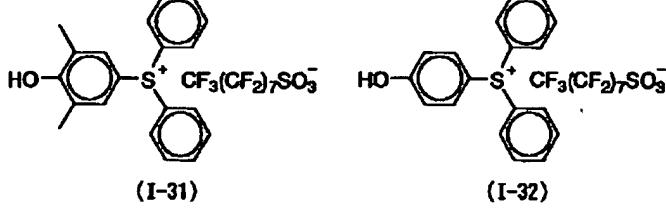
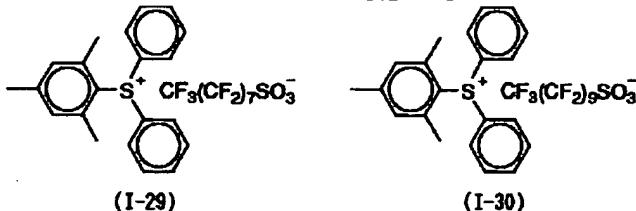


18



[0034]

30【化14】

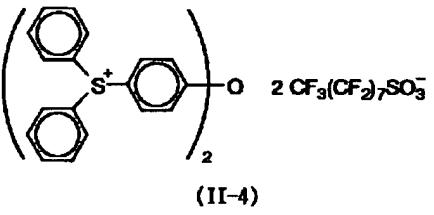
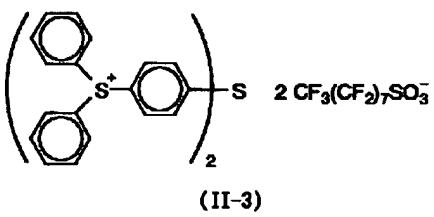
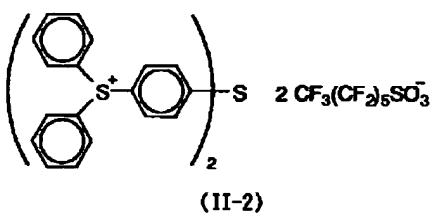
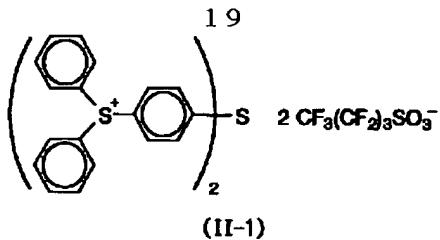


【0035】

【化15】

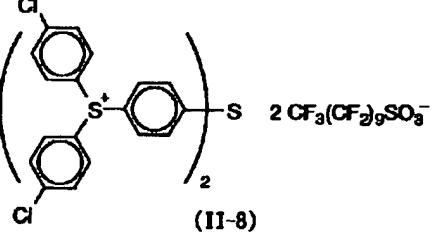
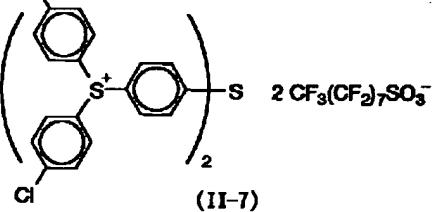
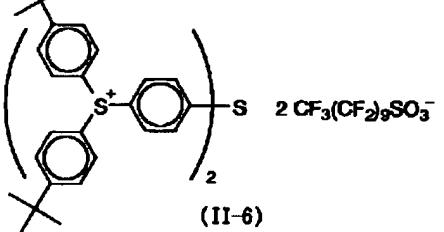
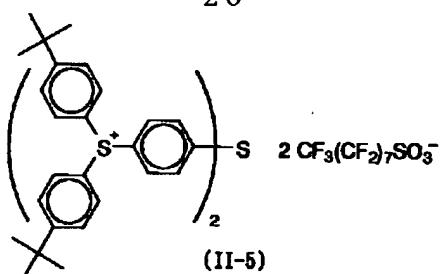
(11)

特開2001-194788



【0036】

【化16】

(11)
 20

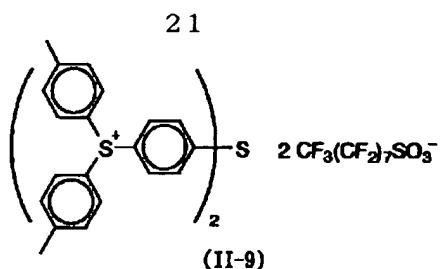
【0037】

【化17】

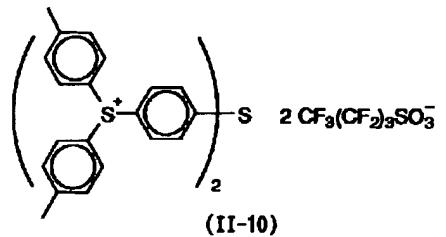
(12)

特開2001-194788

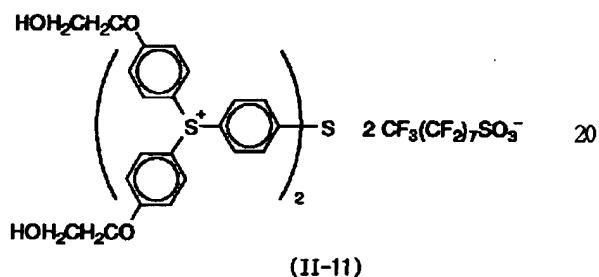
22

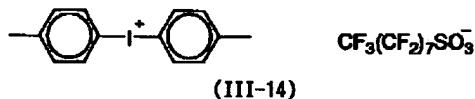
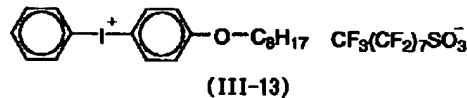
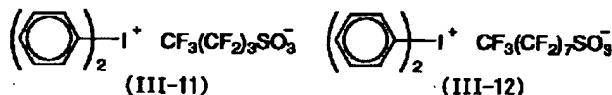
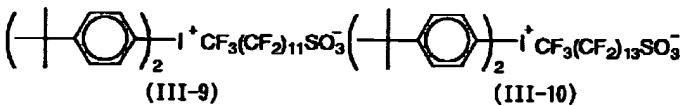
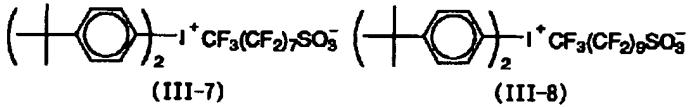
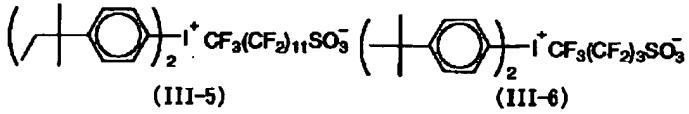
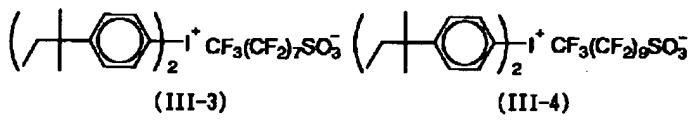
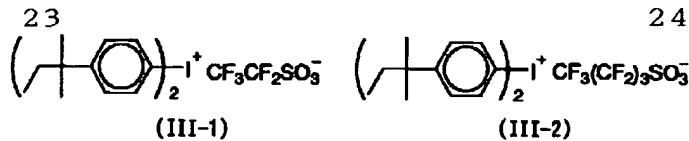
【0038】
【化18】

10

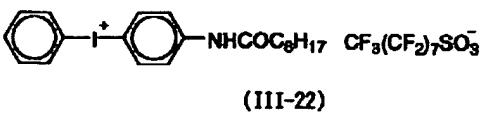
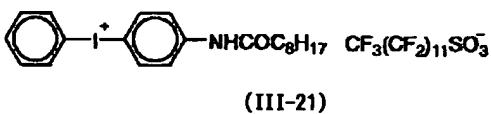
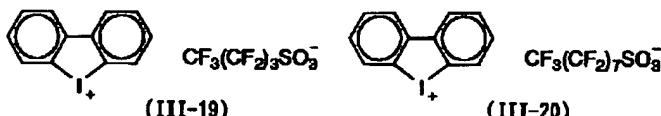
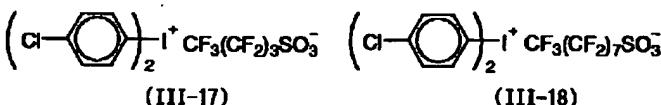
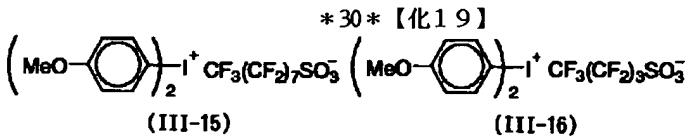


20





【0039】



【0040】上記一般式(I')～(III')で表される(A)光酸発生剤の添加量は、組成物中の固形分を基準として、通常0.001～20重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.01～15重量%、更に好ましくは0.1～10重量%の範囲で使用される。光酸発生剤の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が20重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロファイルの悪化や、プロセス(特にペーク)マージンが狭くなり好ましくない。また、本発明の光酸発生剤に併用可能な光酸発生剤の添加量は、本発明の光酸発生剤に対して200重量%以下であり、好ましくは150重量%以下であり、更に好ましくは100重量%である。

【0041】本発明のポジ型レジスト組成物には、上記一般式(I')～(III')で表される化合物以外の光酸発生剤を併用することができる。併用することができる光酸発生剤としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400～200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0042】また、その他の本発明に併用し得る活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物としては、たとえばS.I.Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387(1974)、T.S.Bal et al, Polymer, 21, 423(1980)等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号、同Re 27,992号、特開平3-140140号等に記載のアンモニウム塩、D.C.Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984)、C.S.Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307(1977)、Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104,143号、米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-150,848号、特開平2-296,514号等に記載のヨードニウム塩、J.V.Crivello et al, Polymer J. 17, 73 (1985)、J.V.Crivello et al, J.Org. Chem., 43, 3055(1978)、W.R.Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789(1984)、J.V.Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279(1985)、J.V.Crivello et al, Macromolecules, 14(5), 1141(1981)、J.V.Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979)、欧州特許第370,693号、同161,811号、同41,0,201号、同339,049号、同233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第3,902,114号同4,933,377号、同4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号、特開平7-28237号、同8-27102号等に記載の

スルホニウム塩、

【0043】J.V.Crivello et al, Macromolecules, 10(6), 1307(1977)、J.V.Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047(1979)等に記載のセレノニウム塩、C.S.Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1988)等に記載のアルソニウム塩等のオニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-239736号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭62-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K.Meier et al, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986)、T.P.Gill et al, Inorg. Chem., 19, 3007(1980)、D.Astruc, Acc. Chem. Res., 19(12), 377(1896)、特開平2-161445号等に記載の有機金属/有機ハロゲン化合物、S.Hayase et al, J. Polymer Sci., 25, 753(1987)、E.Reichmanis et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985)、Q.Q.Zhu et al, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987)、B.Amit et al, Tetrahedron Lett., (24)2205(1973)、D.H.R.Barton et al, J. Chem. Soc., 3571(1965)、P.M.Collins et al, J. Chem. Soc., Perkin I, 1695(1975)、M.Rudinstei et al, Tetrahedron Lett., (17), 1445(1975)、J.W.Walker et al, J. Am. Chem. Soc., 110, 7170(1988)、S.C.Busman et al, J. Imaging Technol., 11(4), 191(1985)、H.M.Houlihan et al, Macromolecules, 21, 2001(1988)、P.M.Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 532(1972)、S.Hayase et al, Macromolecules, 18, 1799(1985)、E.Reichman et al, J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol., 130(6)、F.M.Houlihan et al, Macromolecules, 21, 2001(1988)、欧州特許第0290,750号、同046,083号、同156,535号、同271,851号、同0,388,343号、米国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載のO-ニトロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、M.TUNOOKA et al, Polymer Preprints Japan, 35(8)、G.Berner et al, J. Rad. Curing, 13(4)、W.J.Mijs et al, Coating Technol., 55(697), 45(1983)、Akzo, H.Adachi et al, Polymer Preprints, Japan, 37(3)、欧州特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、同618,564号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、同4,431,774号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特開平3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表される光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭61-166544号、特開平2-71270号等に記載のジスルホン化合物、特開平3-103854号、同3-103856号、同4-210960号等に記載のジアゾケトスルホン、ジアゾジスルホン化合物を挙げることができる。

【0044】また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖または側鎖に導入した化合物、たとえば、M.E.Woodhouse et al, J. Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982)、S.P.Pappas et al, J. Imaging Sci.,

30(5), 218(1986)、S. Kondo et al., *Makromol. Chem., Rapid Commun.*, 9, 625(1988)、Y. Yamada et al., *Makromol. Chem.*, 1 52, 153, 163(1972)、J. V. Crivello et al., *J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed.*, 17, 3845(1979)、米国特許第3,849,13 7号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-14602 9号等に記載の化合物を用いることができる。

【0045】さらにV. N. R. Pillai, *Synthesis*, (1), 1(19 80)、A. Abad et al., *Tetrahedron Lett.*, (47) 4555(19 10 1)、D. H. R. Barton et al., *J. Chem. Soc.*, (C), 329(197 0)、米国特許第3,779,778号、歐州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

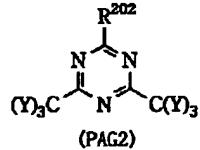
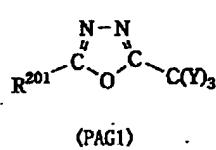
【0046】上記の併用できる光酸発生剤の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG 1) で表されるオキサゾール誘導体または一般式 (PAG 2) で表されるS-トリアジン誘導体。

【0047】

10

【化20】



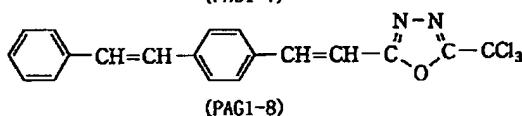
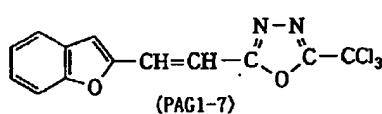
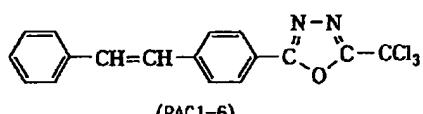
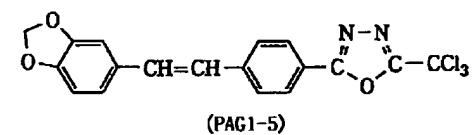
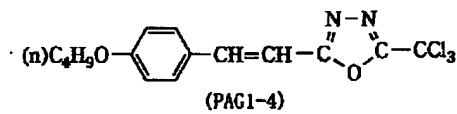
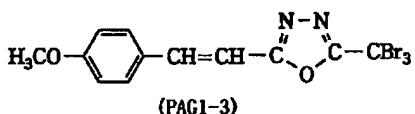
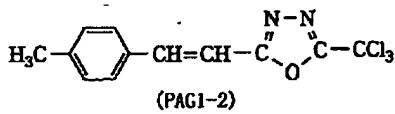
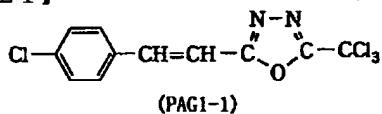
20

【0048】式中、R²⁰¹は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R²⁰²は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)₃をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0049】

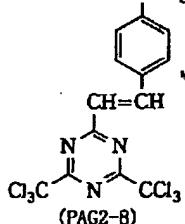
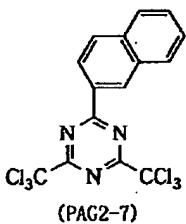
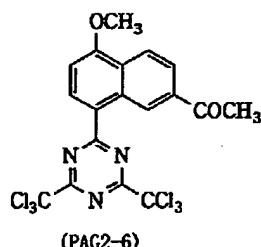
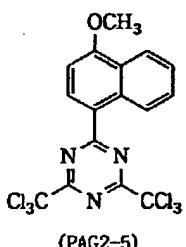
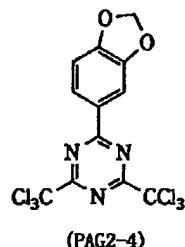
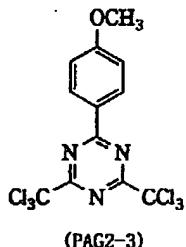
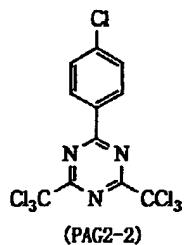
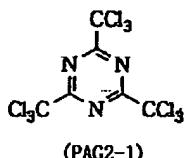
30

【化21】



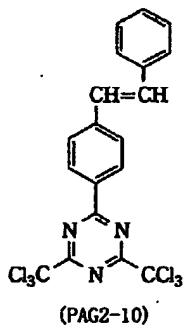
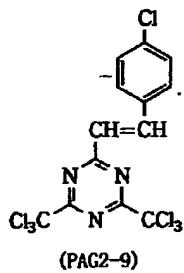
【0050】

【化22】



【0051】

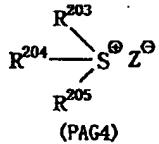
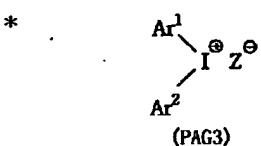
【化23】



【0052】(2)下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、または一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

【0053】

【化24】



【0054】ここで式Ar¹、Ar²は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキカルボニル基、ヒドロキシ基、メルカト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0055】R²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵は各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6～14のアリール基、炭素数1～8のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1～8のアルコキシ基、炭素数1～8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒドロキシ基およびハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1～8のアルコキシ

*

50

基、カルボキシリル基、アルコシキカルボニル基である。

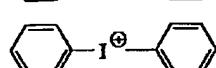
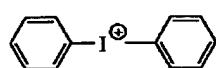
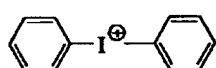
【0056】Z-は対アニオンを示し、例えばBF₄⁻、AsF₆⁻、PF₆⁻、SbF₆⁻、SiF₆²⁻、ClO₄⁻、CF₃SO₃⁻等のパーカルオロアルカンスルホン酸アニオン、ペントフルオロベンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0057】またR²⁰³、R²⁰⁴、R²⁰⁵のうちの2つおよびAr¹、Ar²はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

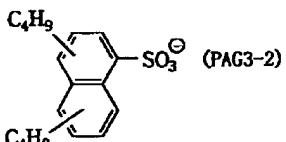
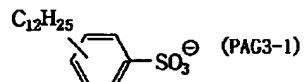
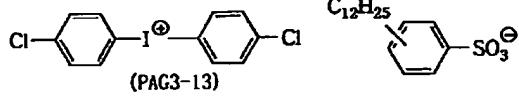
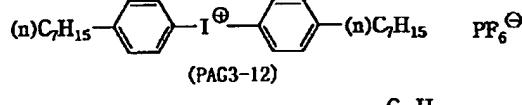
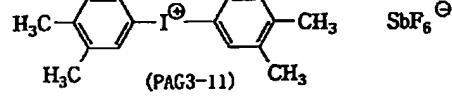
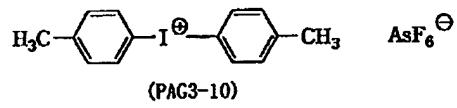
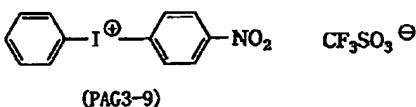
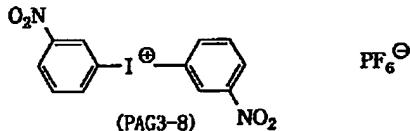
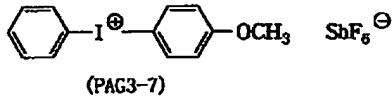
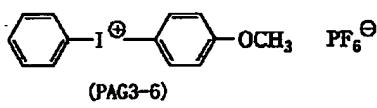
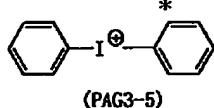
【0058】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0059】

*【化25】



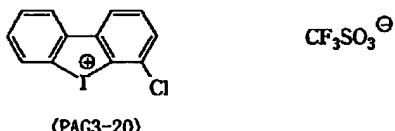
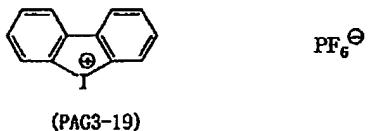
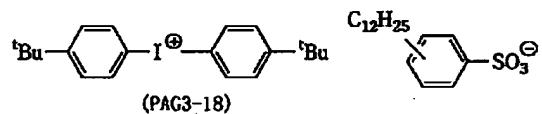
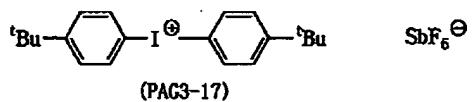
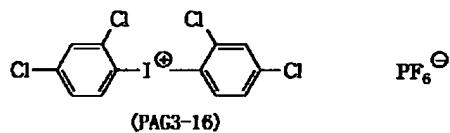
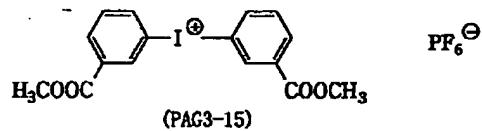
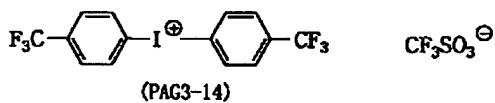
【0060】
【化26】

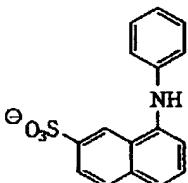
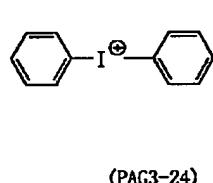
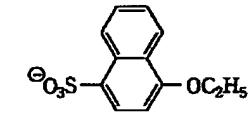
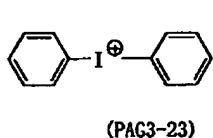
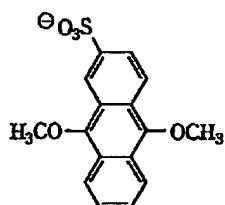
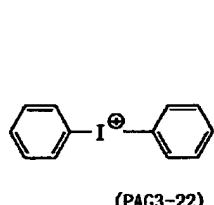
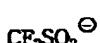
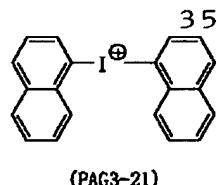


【0061】

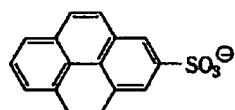
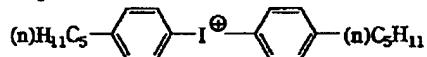
* * 【化27】

33

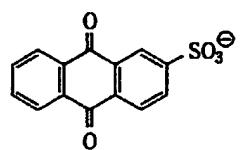
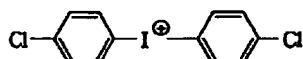




【0063】
【化29】



(PAG3-25)



(PAG3-26)

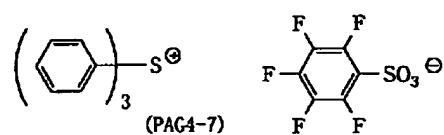
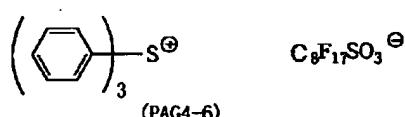
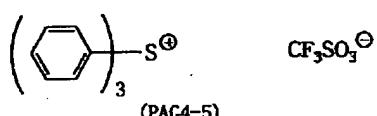
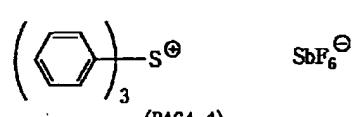
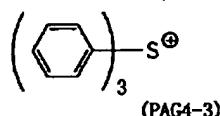
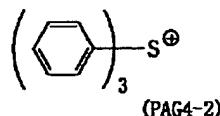
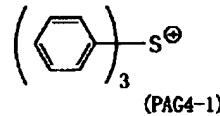
10

20

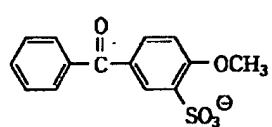
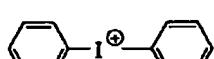
30

40

【0064】
【化30】

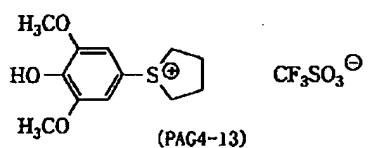
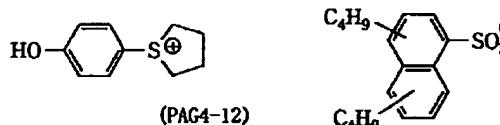
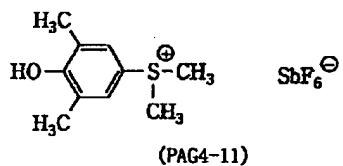
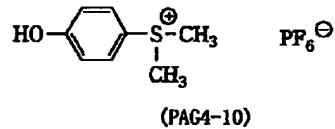
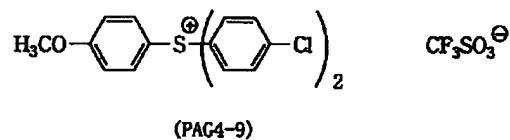
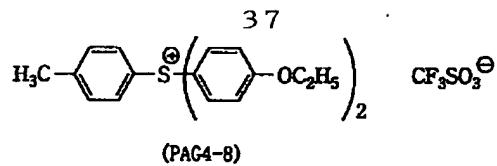


【0065】
【化31】

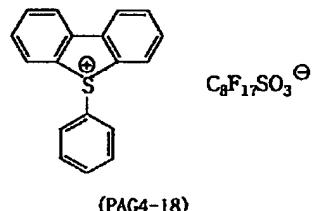
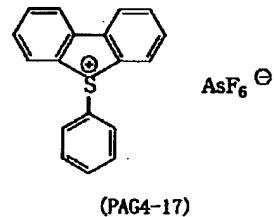
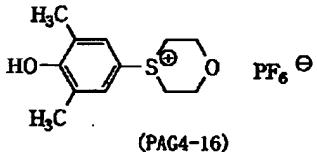
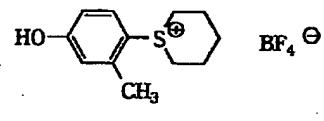
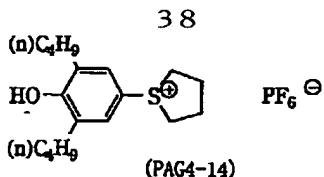


(PAG3-27)

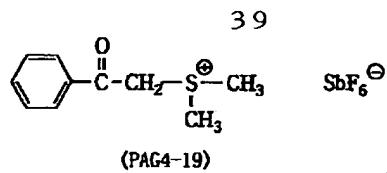
50



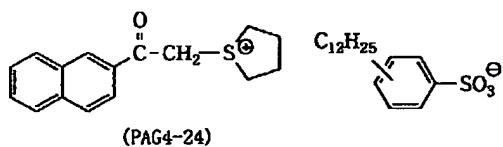
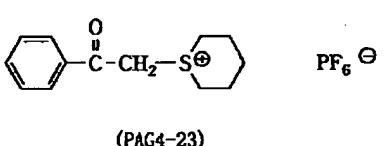
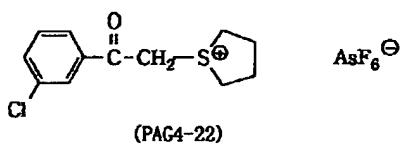
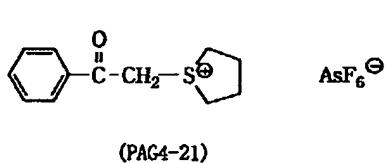
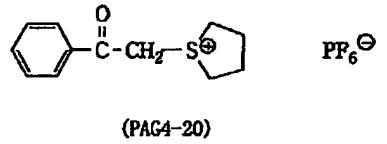
【0066】
【化32】



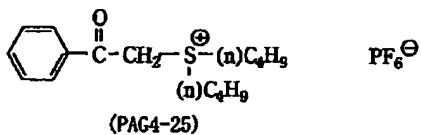
30
【0067】
【化33】



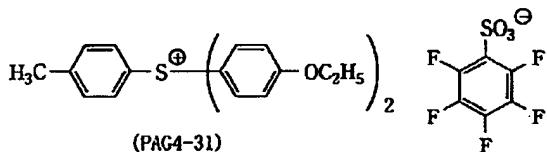
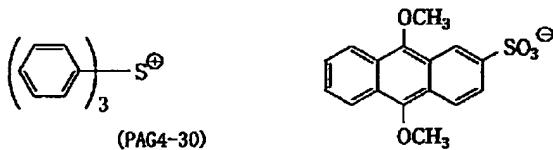
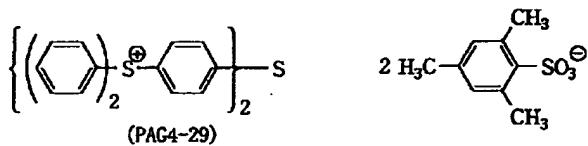
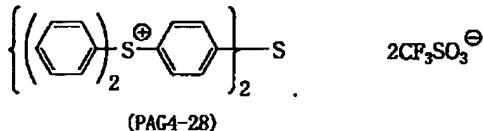
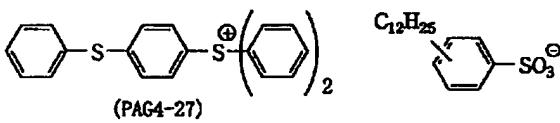
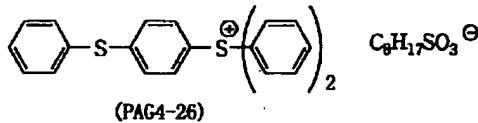
【0068】
【化34】



41

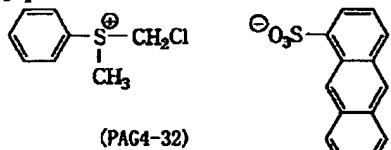


42



【0069】

【化35】



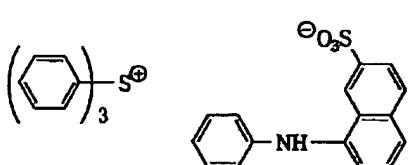
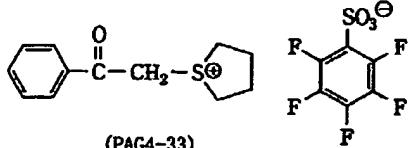
* 【0070】一般式 (PAG3)、(PAG4) で示さ

れる上記オニウム塩は公知であり、例えば J. W. Knapcz
yk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A. L.
Maycock et al, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970)、E.
Goethas et al, Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (19
64)、H. M. Leicester, J. Am. Chem. Soc., 51, 3587
(1929)、J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed.,
18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号および同4,24
40 7,473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成
することができる。

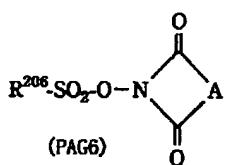
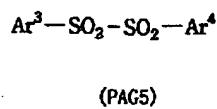
40 * 【0071】(3) 下記一般式 (PAG5) で表される
ジスルホン誘導体または一般式 (PAG6) で表される
イミノスルホネート誘導体。

【0072】

【化36】



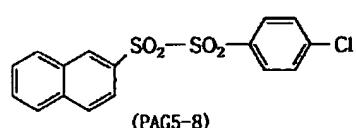
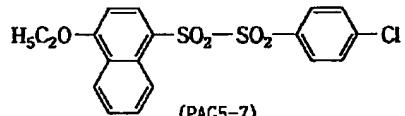
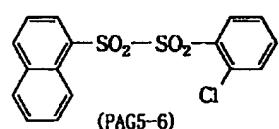
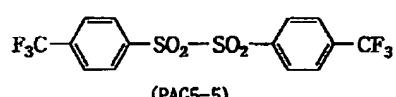
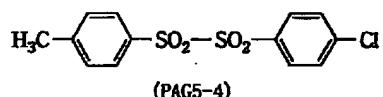
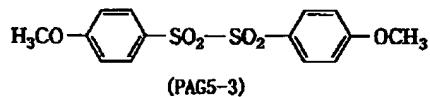
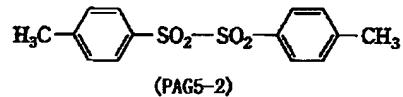
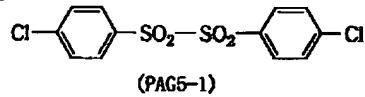
43



【0073】式中、 Ar^3 、 Ar^4 は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。 R^{206} は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。 A は置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例として以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0074】

【化37】



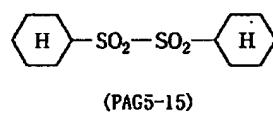
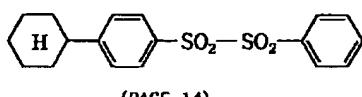
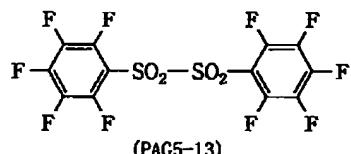
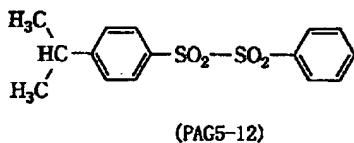
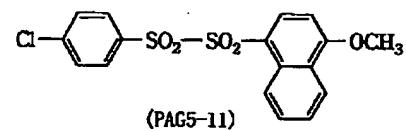
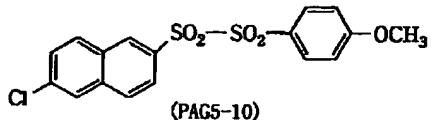
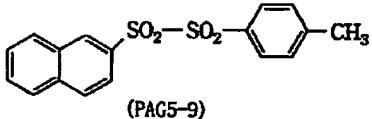
10

20

30

40

44

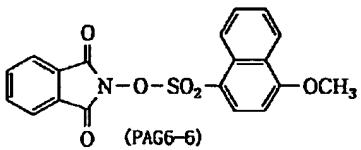
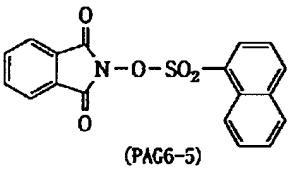
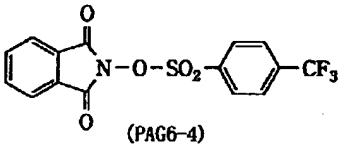
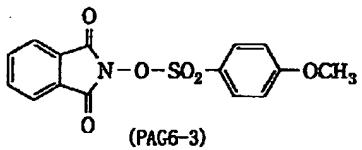
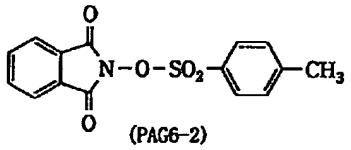
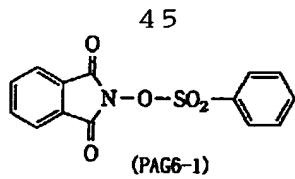


【0076】

【化39】

【0075】

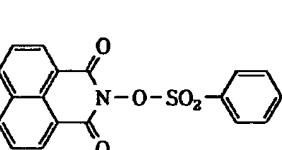
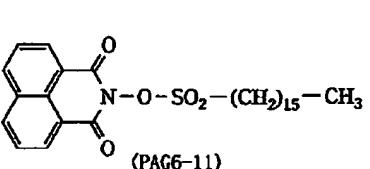
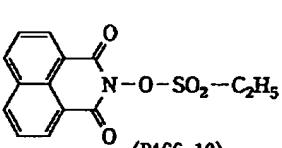
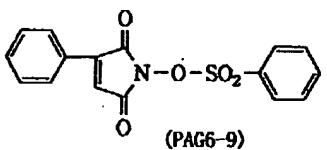
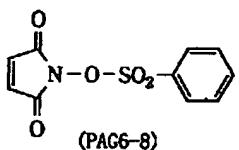
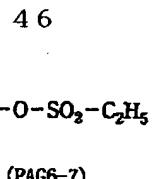
【化38】



10

20

30

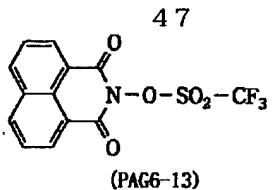


【0077】

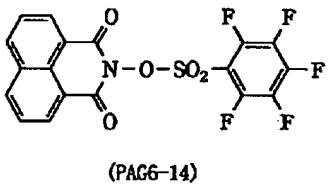
【化40】

【0078】

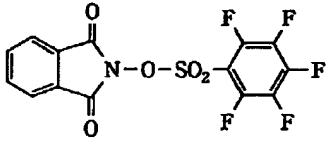
【化41】



47



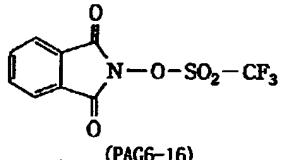
(PAG6-14)



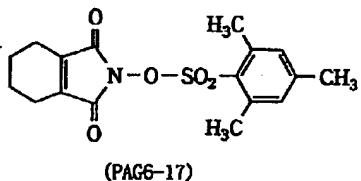
(PAG6-15)

[0079]

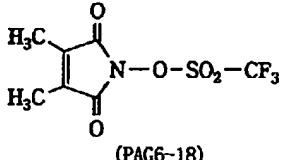
【化4 2】



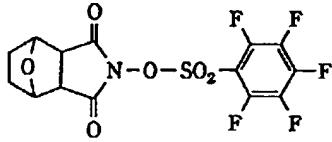
(PAG6-16)



(PAG6-17)



(PAG6~18)

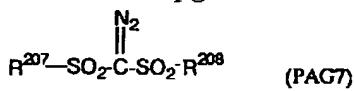


(PAGE 19)

【0080】(4) ジアゾジスルホン誘導体化合物
ジアゾジスルホン誘導体化合物としては、下記一般式
(PAG7) で示されるものが挙げられる。

[0081]

【化43】



48

(PAG7)

【0082】ここでR²¹、R²²は、それぞれ独立して、置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、置換基を有していても良いアリール基を表す。アルキル基としては、炭素数が1～20までの直鎖状または分岐状のアルキル基が好ましく、さらに好ましくは炭素数1～12の直鎖状または分岐状のアルキル基が好ましい。シクロアルキル基としては、シクロペンチル基もしくはシクロヘキシル基が好ましい。アリール基としては、炭素数6～10の置換基を有していても良いアリール基が好ましい。

【0083】ここで置換基としては、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、s-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基等のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基、ハロゲン原子、ニトロ基、アセチル基などが挙げられる。

【0084】ジアゾジスルフォン誘導体化合物の具体例としては、下記化合物が挙げられる。ビス(メチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(エチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(プロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(1-メチルプロピルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(ブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(1-メチルブチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(ヘプチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(オクチルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(ノナ

30 ル) ジアゾメタン、ビス(ノニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(デシルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(オクチルスルホニル)ジアゾメタン

(トアシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(トリフルオロメチルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(シクロヘキシルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(ベンジルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(2-クロロベンジルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(4-クロロベンジルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(フェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(4-メトキシフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス(2-メチルフェニルスルホニル)

40 ジアゾメタン、ビス(3-メチルフェニルスルホニル)
ジアゾメタン、ビス(4-メチルフェニルスルホニル)
ジアゾメタン、ビス(2-4-ジメチルフェニルスルホニル)

ジアゾメタン、ビス (2, 4-ジメチルフェニルホニル) ジアゾメタン、ビス (2, 5-ジメチルフェニルスルホニル) ジアゾメタン、ビス (3, 4-ジメチルフ

エニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス

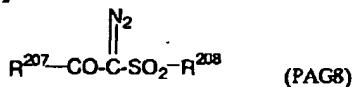
(4-フルオロフェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(2,4-ジフルオロフェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(2,4,6-トリフルオロフェニルスルホニル)ジアゾメタン、ビス(4-ニトロフェニルスルホニル)ジアゾメタン、

ニル) ジアゾメタン。

【0085】(5) ジアゾケトスルホン誘導体化合物
ジアゾケトスルホン誘導体化合物としては、下記一般式
(PAG8) で示されるものが挙げられる。

【0086】

【化44】



【0087】ここでR²¹、R²²は、上記(PAG7)の
R²¹、R²²と同義である。ジアゾケトスルファン誘導体
化合物の具体例としては、下記化合物が挙げられる。

【0088】メチルスルホニルベンゾイルジアゾメ
タン、エチルスルホニルベンゾイルジアゾメタン、
メチルスルホニル-4-プロモベンゾイルジアゾメタ
ン、エチルスルホニル-4-プロモベンゾイルジアゾ
メタン、フェニルスルホニルベンゾイルジアゾメタ
ン、フェニルスルホニル-2-メチルフェニルジアゾ
メタン、フェニルスルホニル-3-メチルフェニルジ
アゾメタン、フェニルスルホニル-4-メチルフェニル
ジアゾメタン、フェニルスルホニル-3-メトキシフ
ェニルジアゾメタン、フェニルスルホニル-4-メト
キシフェニルジアゾメタン、フェニルスルホニル-3
-クロロベンゾイルジアゾメタン、フェニルスルホニ
ル-4-クロロフェニルジアゾメタン、トリルスルホ
ニル-3-クロロベンゾイルジアゾメタン、トリルス
ルホニル-4-クロロフェニルジアゾメタン、フェニ
ルスルホニル-4-フルオロフェニルジアゾメタン、
トリルスルホニル-4-フルオロフェニルジアゾメタ
ン。

【0089】次に(B)上記酸分解性樹脂(酸分解性樹
脂ともいう)について説明する。式(I)において、Y
は水素原子、メチル基、シアノ基、塩素原子から選ばれ
る基を表す。Lは単結合または2価の連結基を表す。

R'、R''、R'''はそれぞれ独立に直鎖または分岐を有
するアルキル基、フェニル基、トリアルキルシリル基、
トリアルキルシリルオキシ基を表す。上記Lにおける2
価の連結基としては、アルキレン基、置換アルキレン
基、橋かけ構造を有していてもよいシクロアルキレン
基、エーテル基、チオエーテル基、カルボニル基、エス
テル基、アミド基、スルファンアミド基、ウレタン基、
ウレア基よりの群から選択される単独あるいは2つ以上
の基の組み合わせが挙げられる。

【0090】上記Lにおけるアルキレン基、置換アルキ
レン基としては、下記式で表される基を挙げることがで
きる。- [C(R α)(R β)]_r - 式中、R α 、R β
は、水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン
原子、水酸基、アルコキシ基を表し、両者は同一でも異
なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エ
チル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低
50

級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エ
チル基、プロピル基、イソプロピル基である。置換アル
キル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アル
コキシ基を挙げることができる。アルコキシ基として
は、メトキシ基、エトキシ基、アロポキシ基、ブトキシ
基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。ハ
ロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原
子、沃素原子等を挙げることができる。rは1~10の
整数を表す。橋かけ構造を有していてもよいシクロアル
キレン基としては、炭素数5~8個のものが挙げられ、
具体的には、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン
基、シクロヘプチレン基、ノルボルニレン基等が挙げら
れる。

【0091】R'、R''、R'''において、上記アルキル
基としては、炭素数1~10の直鎖または分岐のアルキ
ル基が好ましく、より好ましくは炭素数1~6の直鎖ま
たは分岐のアルキル基であり、更に好ましくはメチル
基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-
ブチル基、i-ブチル基、s-ブチル基、t-ブチル基
である。トリアルキルシリル基のアルキル基としては炭
素数1~6の直鎖または分岐のアルキル基であり、更に
好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-
プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、s-ブチル
基、t-ブチル基、中でも最も好ましいのはメチル基で
ある。トリアルキルシリルオキシ基のアルキル基として
は、炭素数1~6の直鎖または分岐のアルキル基であ
り、更に好ましくはメチル基、エチル基、n-プロピル
基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、s-
ブチル基、t-ブチル基であり、中でも最も好ましい
のはメチル基である。上記一般式(I)で表される様り
返し単位の具体例としては、以下のものが挙げられる
が、本発明はこれらの具体例に限定されるものではな
い。

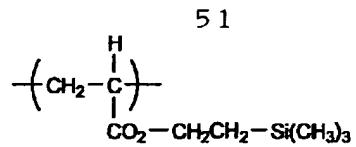
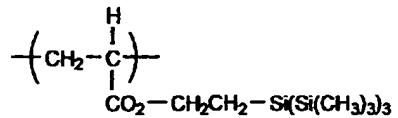
【0092】

【化45】

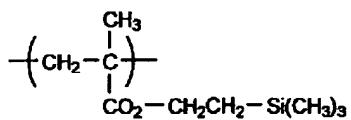
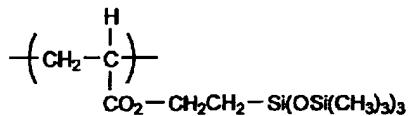
(27)

特開2001-194788

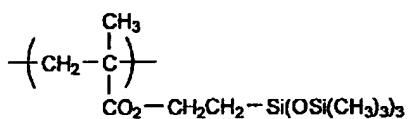
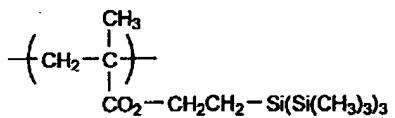
51

【0093】
【化46】

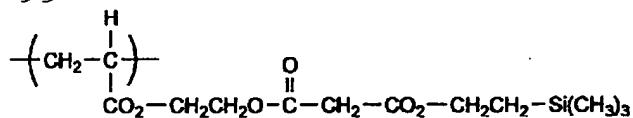
10



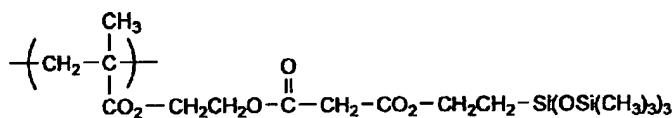
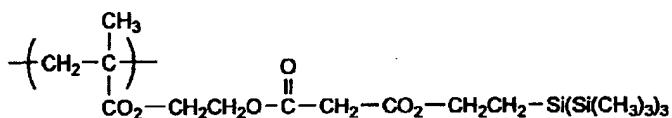
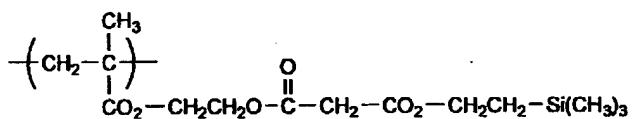
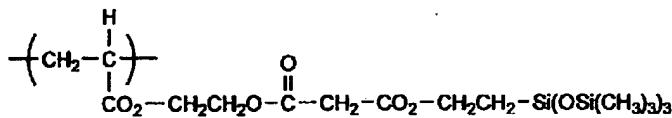
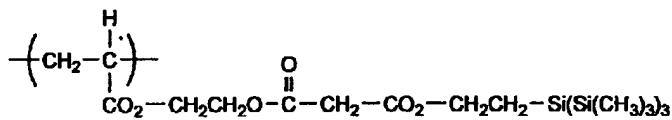
20



53



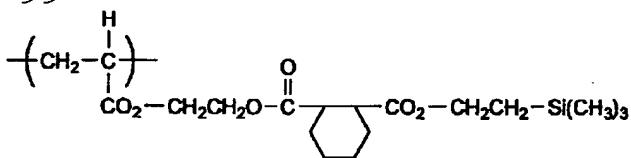
54



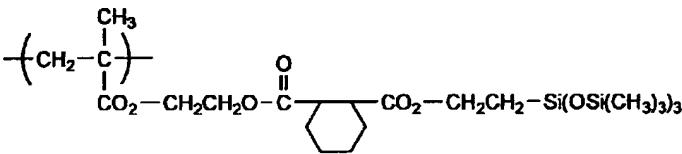
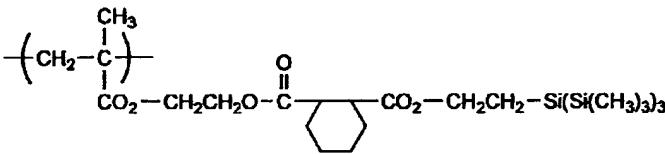
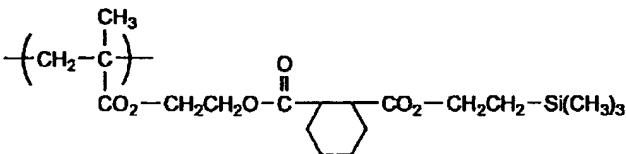
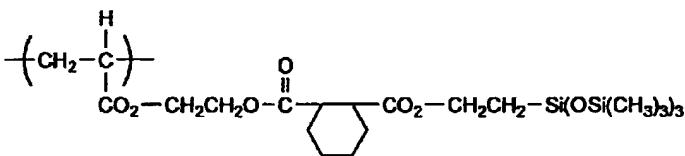
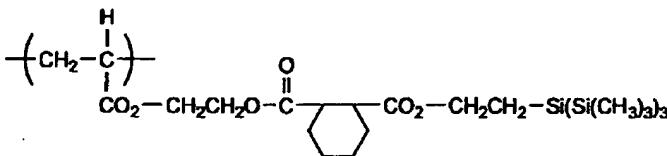
【0094】

* * 【化47】

55



56



【0095】一般式(II)において、Yは水素原子、メチル基、シアノ基または塩素原子を表す。M¹は単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。

【0096】上記M¹におけるアルキレン基、置換アルキレン基としては、下記式で表される基を挙げることができる。

—[C(R γ)(R δ)] s —

式中、R γ 、R δ は水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基またはアルコキシ基を表し、両者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基などの低級アルキル基が好ましく、さらに好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソブロピル基である。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ

*基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、ホウ素原子を挙げることができる。sは1~10の整数を表す。

【0097】アリーレン基としては、炭素数6~10の芳香環基が好ましく、例えばフェニレン基、ナフチレン基が挙げられる。置換アリーレン基の置換基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル等の炭素数1~4のアルキル基、ハロゲン原子、水酸基、メトキシ

40 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基が挙げられる。中でも好ましいM¹の構造として挙げられるのは、単結合及び酸の作用によりエステル基とM¹の間が解離できる様な構造である。この様な構造としては、例えば—C(CH₃)₂—、—C(CH₂CH₃)₂—、—C(CH₃)(CH₂CH₃)—、—C(CH₃)₂CO₂—、—C(CH₂CH₃)₂CO₂—、—C(CH₃)(CH₂CH₃)CO₂—が挙げられる。中でも単結合、—C(CH₃)₂—、—C(CH₃)₂CO₂—が好ましい。

【0098】Qは上記一般式(p I)~(p VI)で表さ

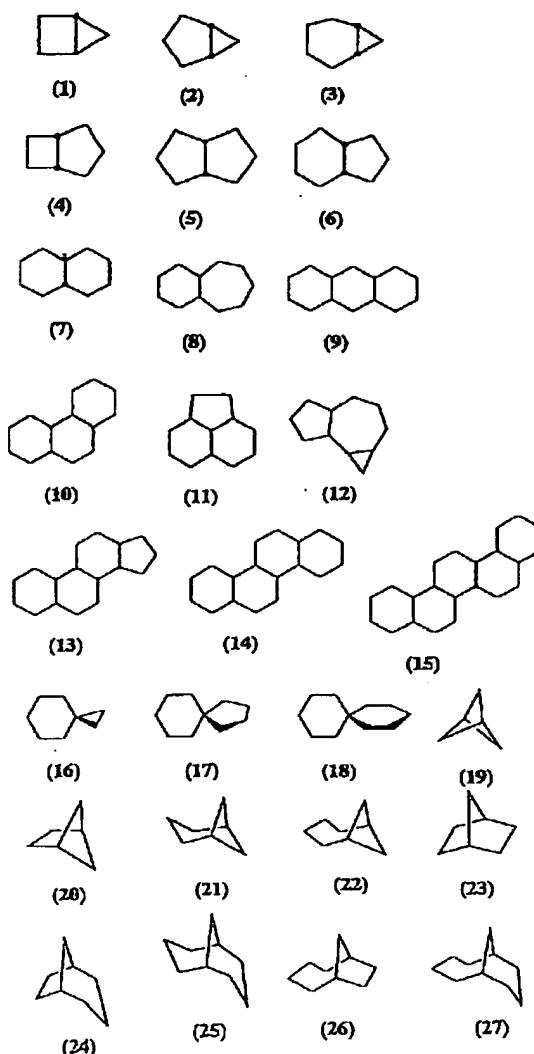
*50

れる脂環式炭化水素構造を含む基を表す。一般式 (p I) ~ (pVI) において、R₁₂~R₂₅におけるアルキル基としては、置換もしくは非置換のいずれであってもよい、1~4個の炭素原子を有する直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。そのアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-ブロピル基、イソブロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基等が挙げられる。また、上記アルキル基の異なる置換基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシ基、アルコキカルボニル基、ニトロ基等を挙げることができる。

【0099】R₁₁~R₂₅における脂環式炭化水素基あるいはZと炭素原子が形成する脂環式炭化水素基としては、単環式でも、多環式でもよい。具体的には、炭素数5以上のモノシクロ、ビシクロ、トリシクロ、テトラシクロ構造等を有する基を挙げることができる。その炭素数は6~30個が好ましく、特に炭素数7~25個が好ましい。これらの脂環式炭化水素基は置換基を有してもよい。以下に、脂環式炭化水素構造を含む基のうち、脂環式部分の構造例を示す。

【0100】

【化48】



【0101】

【化49】

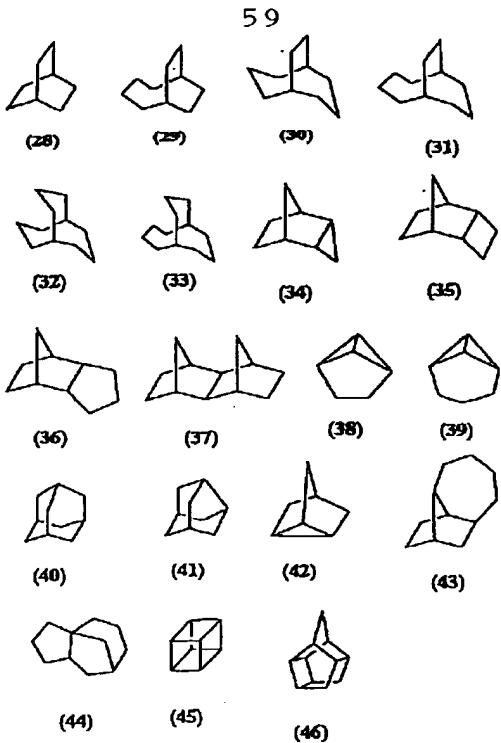
【0103】本発明においては、上記脂環式部分の好ましいものとしては、アダマンチル基、ノルアダマンチル基、デカリン残基、トリシクロデカニル基、テトラシクロデカニル基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基を挙げることができる。より好ましくは、アダマンチル基、デカリン残基、ノルボルニル基、セドロール基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基、シクロデカニル基、シクロドデカニル基である。

【0104】これらの脂環式炭化水素基の置換基としては、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基、アルコキシ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基が挙げられる。アルキル基としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基等の低級アルキル基が好ましく、更に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基である。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基を挙げることができる。該アルコキシ基としてはメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4個のものを挙げることができる。

【0105】上記一般式(II)で表される繰り返し単位の具体例としては、以下のものが挙げられるが、本発明はこれらの具体例に限定されるものではない。

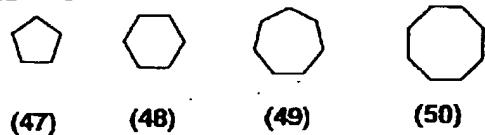
【0106】

【化50】

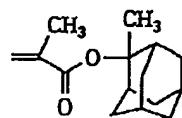


【0102】

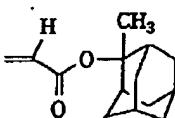
【化50】



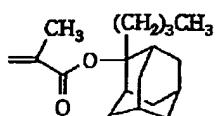
61



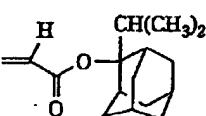
2



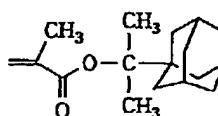
3



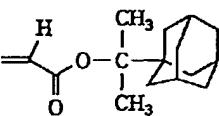
4



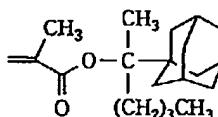
5



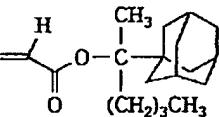
6



7



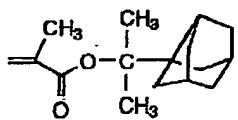
8



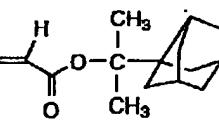
【0107】

* * 【化52】

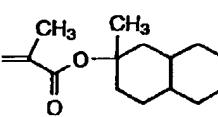
9



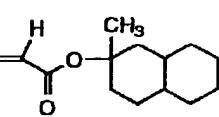
10



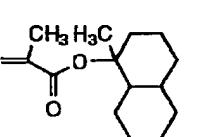
11



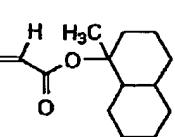
12



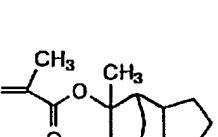
13



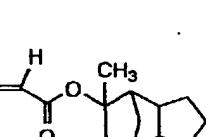
14



15

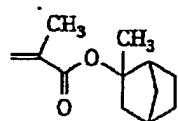


16

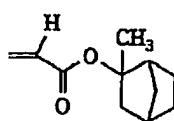


【0108】

* * 【化53】

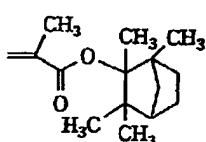
63
17

18

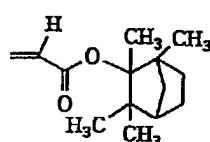


64

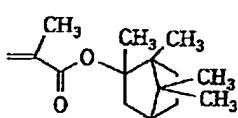
19



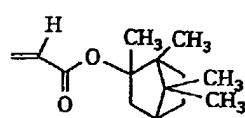
20



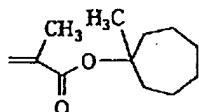
21



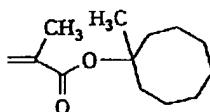
22



23

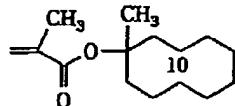


24



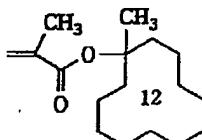
【0109】

25

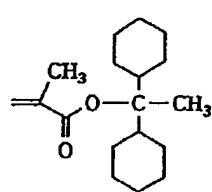


* * 【化54】

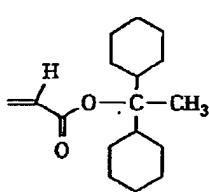
26



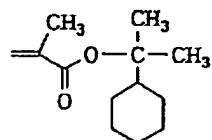
27



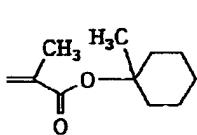
28



29

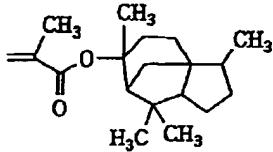


30

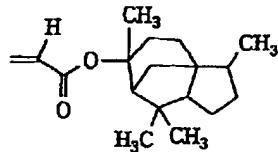


【0110】

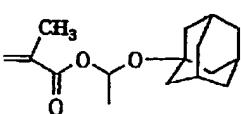
* * 【化55】

65
31

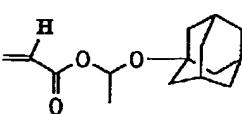
32



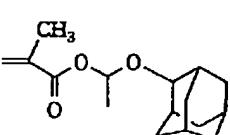
33



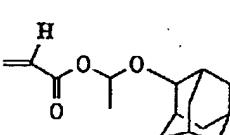
34



35

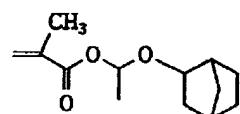


36



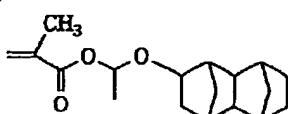
【0111】

37

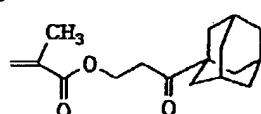


* * 【化56】

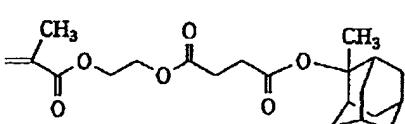
38



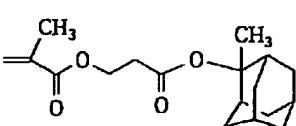
39



40



41



【0112】一般式 (III) において、Yは水素原子、メチル基、シアノ基または塩素原子を表す。M²は、単結合又はアルキレン基、置換アルキレン基、橋かけ構造を有していてもよいシクロアルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エステル基、カルボニル基、アミド基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基からなる群から選択される単独もしくは2つ以上の基の組み合わせからなる2価の連結基を表す。

【0113】上記M²におけるアルキレン基、置換アルキレン基、アリーレン基、置換アリーレン基、エーテル基、チオエーテル基、ウレタン基及びウレア基は、下記式で表される基を挙げることができる。

—[C(R_ε)(R_δ)]_t—

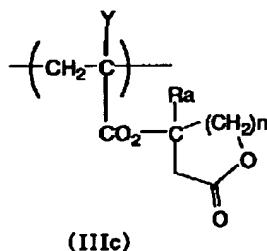
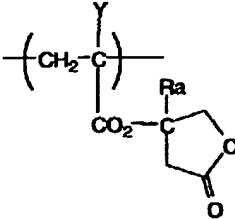
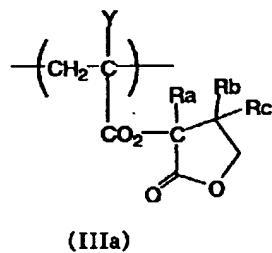
式中、R_ε、R_δは水素原子、アルキル基、置換アルキル基、ハロゲン原子、水酸基またはアルコキシ基を表し、两者は同一でも異なっていてもよい。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基などの低級アルキル基が好ましく、さら

に好ましくはメチル基、エチル基、プロピル基、イソブ

ロピル基である。置換アルキル基の置換基としては、水酸基、ハロゲン原子、アルコキシ基等を挙げることができる。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のものを挙げることができる。ハロゲン原子としては、塩素原子、臭素原子、フッ素原子、ヨウ素原子を挙げることができる。tは1~10の整数を表す。

【0114】橋かけ構造を有していてもよいシクロアルキレン基としては、炭素数5~8個のものが挙げられる。具体的には、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基、シクロヘプチレン基、ノルボルニレン基等が挙げられる。アリーレン基としては、炭素数6~10の芳香環基が好ましく、例えばフェニレン基、ナフチレン基が挙げられる。置換アリーレン基の置換基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル等の炭素数1~4のアルキル基、ハロゲン原子、水酸基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~4のアルコキシ基が挙げられる。中でも好ましいM²の構造として挙げられるのは、単結合及び酸の作用によりエステル基とM²の間が解裂できる様な構造である。この様な構造としては、例えば-C(CH₃)₂-、-C(CH₂CH₃)₂-、-C(CH₃)(CH₂CH₃)-、-C(CH₃)₂CO₂-、-C(CH₂CH₃)₂CO₂-、-C(CH₃)(CH₂CH₃)CO₂-が挙げられる。中でも単結合、-C(CH₃)₂-、-C(CH₃)₂CO₂-が好ましい。

【0115】Raは水素原子または置換基を有していて*



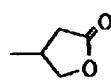
【0120】一般式(IIIa)~(IIIc)において、Y、Raは前記一般式(III)のY、Raと同義である。一般式(IIIa)において、Rb、Rcは水素原子または置換基を有していてよい、直鎖または分岐のアルキル基を表す。具体的にはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、n-ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル基、s-ブチル基等が挙げられる。

* もよい、直鎖もしくは分岐のアルキル基を表す。好ましくは炭素数1~4のアルキル基であり、具体的にはメチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、i-ブチル基、t-ブチル基、s-ブチル基等が挙げられる。ここで直鎖または分岐のアルキル基の置換基としては、炭素数1~4のアルコキシ基、置換基を有していてよいフェノキシ基、ハロゲン原子、アシル基、アシロキシ基、シアノ基、水酸基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ニトロ基等が挙げられる。

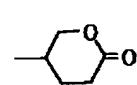
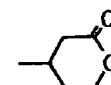
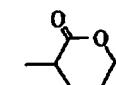
10 20 【0116】Wは、結合する炭素原子と共にラクトン構造を形成するに必要な原子群を表す。上記ラクトン構造は、5又は6員環のラクトンであることが好ましく、より好ましくは下記構造のラクトンである。

【0117】

【化57】



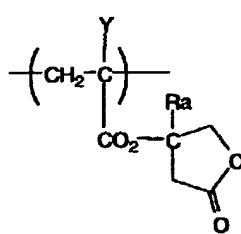
20



【0118】一般式(III)において、好ましい構造としては下記一般式(IIIa)~(IIIc)が挙げられる。

【0119】

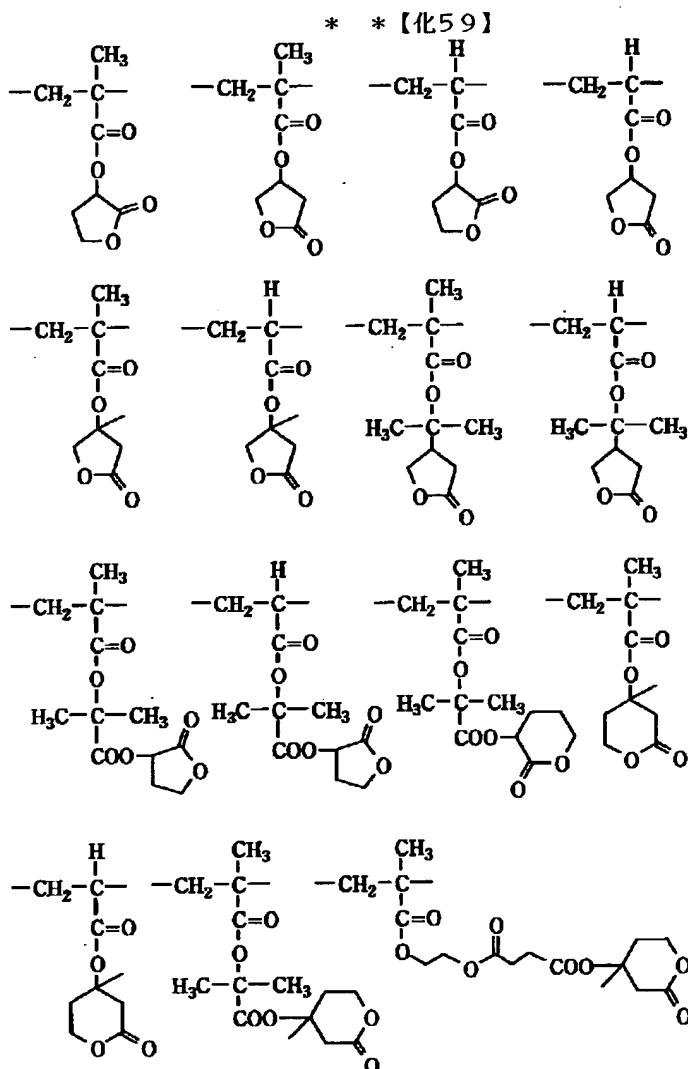
【化58】



(IIIb)

※基、s-ブチル基等が挙げられる。ここで直鎖または分岐のアルキル基の置換基としては、炭素数1~4のアルコキシ基、置換基を有していてよいフェノキシ基、ハロゲン原子等が挙げられる。一般式(IIIc)において、nは2~4の整数を表す。以下に一般式(III)の具体例を挙げる。

[0121]



【0122】本発明に係る樹脂は、本発明の効果が有効に得られる範囲内で、更に以下のような単量体が該樹脂を構成する繰り返し単位を与えるものとして共重合されてもよいが、下記単量体に限定されるものではない。これにより、前記樹脂に要求される性能、特に（1）塗布溶剤に対する溶解性、（2）製膜性（ガラス転移点）、（3）アルカリ現像性、（4）膜べり（親疎水性、アルカリ可溶性基選択）、（5）未露光部の基板への密着性、（6）ドライエッティング耐性、の微調整が可能となる。このような共重合単量体としては、例えば、アクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類等から選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物などを挙げることができる。

【0123】具体的には、例えばアクリル酸エステル類、例えばアルキル（アルキル基の炭素原子数は1～10のものが好ましい）アクリレート（例えば、アクリル

※酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸一七一オクチル、クロルエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2、2-ジメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5-ヒドロキシベンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ベンタエリスリトールモノアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレートなど)；

【0124】メタクリル酸エステル類、例えばアルキル(アルキル基の炭素原子数は1～10のものが好ましい。)メタクリレート(例えばメチルメタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソプロピルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、クロルベンジルメタクリレート。

ト、オクチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロキシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシベンチルメタクリレート、2, 2-ジメチル-3-ヒドロキシプロピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタクリレート、ペントエリスリトールモノメタクリレート、フルフリルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど) ;

【0125】アクリルアミド類、例えばアクリルアミド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、t-ブチル基、ヘプチル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ヒドロキシエチル基などがある。)、N, N-ジアルキルアクリルアミド(アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-アセチルアクリルアミドなど;

【0126】メタクリルアミド類、例えばメタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては炭素原子数1~10のもの、例えばメチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N, N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としてはエチル基、プロピル基、ブチル基などがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミドなど;

【0127】アリル化合物、例えばアリルエステル類(例えば酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど;

【0128】ビニルエーテル類、例えばアルキルビニルエーテル(例えばヘキシルビニルエーテル、オクチルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキシルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエーテル、1-メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニルエーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニルエーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエチルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチルビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒドロフルフリルビニルエーテルなど) ;

【0129】ビニルエステル類、例えばビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチルアセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビニルクロラセテート、ビニルジクロラセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラ

クテート、ビニル-β-フェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレートなど;

【0130】イタコン酸ジアルキル類(例えばイタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど) ; アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、イタコン酸、アクリロニトリル、メタクリロニトリル等がある。

【0131】本発明に係る樹脂において、一般式(I)で表される繰り返し単位、並びに一般式(II)及び(II-I)で表される繰り返し単位の含有量は、所望のレジストのO₂プラズマエッティング耐性、感度、パターンのクラッキング防止、基板密着性、レジストプロファイル、さらには一般的なレジストの必要要件である解像力、耐熱性、等を勘案して適宜設定することができる。一般的に、本発明に係る樹脂における一般式(I)で表される繰り返し単位と一般式(II)で表される繰り返し単位のモル比率(一般式(I) : 一般式(II))は5:95~99:1、好ましくは7:93~95:5であり、更に好ましくは10:90~90:10である。一般式(I)で表される繰り返し単位と一般式(III)で表される繰り返し単位のモル比率(一般式(I) : 一般式(III))は、5:95~99:1、好ましくは7:93~95:5であり、更に好ましくは10:90~90:10である。

【0132】また、一般式(I)で表される繰り返し単位と一般式(II)で表される繰り返し単位に更に一般式(III)で表される繰り返し単位を含有する酸分解性樹脂においては、その全単量体繰り返し単位中において、一般式(III)で表される繰り返し単位が5モル%以上含有されることが好ましく、より好ましくは10モル%以上、さらに好ましくは20モル%以上である。

【0133】また、上記以外の更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位の樹脂中の含有率も所望のレジストの性能に応じて適宜設定することができるが、一般的に、本発明の酸分解性樹脂の全単量体繰り返し単位において、上記更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位は50モル%以下含有することが適当であり、好ましくは40モル%以下、更に好ましくは30モル%以下である。この更なる共重合成分の単量体に基づく繰り返し単位の量がこの範囲内において、本発明の効果を十分に発揮しつつ、該共重合成分による改良効果を良好に発現することができる。

【0134】本発明の酸分解性樹脂は、一般式(I)及び一般式(II)で表される繰り返し単位に相当するする各単量体、あるいは一般式(I)及び一般式(III)で表される繰り返し単位に相当するする各単量体、あるいは一般式(I)、一般式(II)及び一般式(III)で表される繰り返し単位に相当するする各単量体を、ラジカル重合開始剤の存在下で共重合して合成することができる。また、本発明の酸分解性樹脂において、上記更なる共重合成分を含有する場合には、一般式(I)及び一般

式(II)で表される繰り返し単位に相当する各单量体、あるいは一般式(I)及び一般式(III)で表される繰り返し単位に相当する各单量体、あるいは一般式(I)、(II)及び(III)で表される繰り返し単位に相当する各单量体に、該共重合成分に相当する单量体を加えてラジカル重合することで合成することができる。

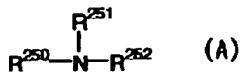
【0135】本発明に係る樹脂の重量平均分子量は、GPC法によりポリスチレン換算値として、好ましくは1,000~200,000である。重量平均分子量が1,000未満では耐熱性やドライエッキング耐性の劣化が見られるため余り好ましくなく、200,000を越えると現像性が劣化したり、粘度が極めて高くなるため製膜性が劣化するなど余り好ましくない結果を生じる。

【0136】本発明のポジ型フォトレジスト組成物において、本発明に係る樹脂(ポリマー)の組成物全体中の配合量は、全レジスト固体分中40~99.99重量%が好ましく、より好ましくは50~99.97重量%である。

【0137】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、有機塩基性化合物を含有することが好ましい。これにより経時での感度変動が小さくなる。有機塩基性化合物としては、以下のものが挙げられる。

【0138】

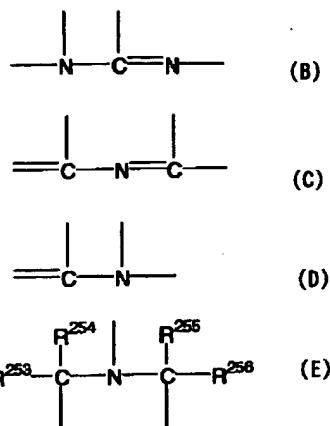
【化60】



【0139】ここで、R²⁵⁰、R²⁵¹およびR²⁵²は、同一または異なり、水素原子、炭素数1~6のアルキル基、炭素数1~6のアミノアルキル基、炭素数1~6のヒドロキシアルキル基または炭素数6~20の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここでR²⁵¹とR²⁵²は互いに結合して環を形成してもよい。

【0140】

【化61】



【0141】(式中、R²⁵³、R²⁵⁴、R²⁵⁵およびR²⁵⁶ 50 級モルホリン誘導体、特開平11-52575号公報に

は、同一または異なり、炭素数1~6のアルキル基を示す)

【0142】更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置換もしくは未置換のインダゾール、置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のアミノビロリジン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしくは未置換のビラゾリン、置換もしくは未置換のビペラジン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。

【0143】好ましい具体的化合物として、グアニジン、1,1-ジメチルグアニジン、1,1,3,3-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ビペラジン、N-(2-アミノエチル)ビペラジン、N-(2-アミノエチル)ビペリジン、4-アミノ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン、4-ビペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ビラゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリミジン、2,4-ジアミノピリミジン、4,6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリン、1,5-ジアザビシクロ[4,3,0]ノナ-5-エン、1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]ウンデカ-7-エン、2,4,5-トリフェニルイミダゾール、N-メチルモルホリン、N-エチルモルホリン、N-ヒドロキシエチルモルホリン、N-ベンジルモルホリン、シクロヘキシルモルホリノエチルチオウレア(CHMETU)等の3

記載のヒンダードアミン類（例えば該公報〔0005〕に記載のもの）等が挙げられるがこれに限定されるものではない。

【0144】特に好ましい具体例は、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノネン、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン、4-ジメチルアミノビリジン、ヘキサメチレンテトラミン、4,4-ジメチルイミダゾリン、ピロール類、ピラゾール類、イミダゾール類、ピリダジン類、ピリミジン類、CHMETU等の3級モルホリン類、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ビペリジル)セバゲート等のヒンダードアミン類等を挙げることができる。

【0145】中でも、1,5-ジアザビシクロ[4,3,0]ノナ-5-エン、1,8-ジアザビシクロ[5,4,0]ウンデカ-7-エン、1,4-ジアザビシクロ[2,2,2]オクタン、4-ジメチルアミノビリジン、ヘキサメチレンテトラミン、CHMETU、ビス(1,2,2,6,6-ペンタメチル-4-ビペリジル)セバゲートが好ましい。

【0146】これらの有機塩基性化合物は、単独あるいは2種以上組み合わせて用いられる。有機塩基性化合物の使用量は、レジスト組成物の全固形分に対し、通常、0.001～10重量%、好ましくは0.01～5重量%である。0.001重量%未満では上記有機塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量%を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

【0147】本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、界面活性剤を含有することが好ましく、特にフッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤、ノニオン系界面活性剤の少なくとも1種の界面活性剤を含有することが好ましい。中でもフッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤が特に好ましい。これにより疎密依存性が改良される。これらの界面活性剤として、例えば特開昭62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-230165号、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-5988号記載の界面活性剤を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま用いることもできる。

【0148】使用できる市販の界面活性剤として、例えばエフトップEF301、EF303、(新秋田化成(株)製)、フローラードFC430、431(住友スリーエム(株)製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08(大日本インキ(株)製)、サーフロンS-382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子(株)製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル(株)製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤を挙げることができる。またポリシ

10

20

30

40

50

ロキサンポリマーKP-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性剤として用いることができる。

【0149】他の界面活性剤としては、具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル類、ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノオレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタントリスティアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリオキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシエチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチレンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレンソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビタントリスティアレート等のポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤等を挙げることができる。界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%～2重量%、好ましくは0.01重量%～1重量%である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

【0150】本発明のポジ型フォトレジスト組成物には、必要に応じて更に酸分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、上記以外の界面活性剤、光増感剤、および現像液に対する溶解性を促進させる化合物等を含有させることができる。

【0151】本発明のこのようなポジ型フォトレジスト組成物は基板上に塗布され、薄膜を形成する。この塗膜の膜厚は0.4～1.5μmが好ましい。上記組成物を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは250nm以下、より好ましくは220nm以下の波長の遠紫外線である。具体的には、KrFエキシマレーザー(248nm)、ArFエキシマレーザー(193nm)、F2エキシマレーザー(157nm)、X線、電子ビーム等が挙げられ、特にArFエキシマレーザー(193nm)が好ましい。

【0152】本発明の遠紫外線露光用ポジ型フォトレジスト組成物の現像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、n-プロピルアミン等の第一アミン類、

ジエチルアミン、ジ-n-ブチルアミン等の第二アミン類、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド等の第四級アンモニウム塩、ピロール、ビヘリジン等の環状アミン類等のアルカリ性水溶液を使用することができる。更に、上記アルカリ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適量添加して使用することもできる。

【0153】本発明のポジ型フォトレジスト組成物によるレジストを2層レジストの上層レジストとして使用する場合、上層レジストパターンを保護マスクとして下層の有機高分子膜の酸素プラズマによるエッチングが行なわれるが、この上層レジストは酸素プラズマに対する十分な耐性を有する。本発明のポジ型フォトレジスト組成物の酸素プラズマ耐性は上層レジストのシリコン含有量や、エッチング装置、及びエッチング条件にも依存するが、エッチング選択比（下層と上層レジストとのエッチング速度比）は10～100と充分大きく取ることができる。

【0154】また、本発明のポジ型フォトレジスト組成物によるパターン形成方法においては、まず、被加工基板上有機高分子膜を形成する。この有機高分子膜は各種公知のフォトレジストでよく、たとえば、フジフィルムオーリン社製FHシリーズ、FH iシリーズあるいはオーリン社製O i Rシリーズ、住友化学社製PFIシリーズの各シリーズを例示することができる。この有機高分子膜の形成は、これらを適当な溶剤に溶解させ、得られる溶液をスピンドル法、スプレイ法等により塗布することにより行なわれる。次いで、上記有機高分子膜の第1層上に、本発明のポジ型フォトレジスト組成物の膜を形成する。これは第1層と同様にレジスト材料を適当な溶剤に溶解させ、得られる溶液をスピンドル法、スプレイ法等により塗布することにより行なわれる。得られた2層レジストは次にパターン形成工程に付されるが、その第1段階として、まず第2層、すなわち上層のフォトレジスト組成物の膜にパターン形成処理を行なう。必要に応じてマスク合わせを行ない、このマスクを通して高エネルギー線を照射することにより、照射部分のフォトレジスト組成物をアルカリ水溶液に可溶とし、アルカリ水溶液で現像してパターンを形成する。

【0155】次いで、第2段階として有機高分子膜のエッチングを行なうが、この操作は上記のレジスト組成物の膜のパターンをマスクとして酸素プラズマエッチングにより実施し、アスペクト比の高い微細なパターンを形成する。この酸素プラズマエッチングによる有機高分子膜のエッチングは、従来のホトエッチング操作による基板のエッチング加工の終了後に行なわれるレジスト膜の剥離の際に利用されるプラズマアッティングとまったく同

一の技術である。この操作は、例えば円筒形プラズマエッティング装置、平行平坂形プラズマエッティング装置により、反応性ガス、すなわちエッティングガスとして酸素を使用して実施することができる。さらに、このレジストパターンをマスクとして基板の加工が行なわれるが、加工法としてはスパッタエッティング、ガスプラズマエッティング、イオンビームエッティング等のドライエッティング法を利用することができる。

【0156】本発明のレジスト膜を含む2層膜レジスト法によるエッチング処理は、レジスト膜の剥離操作によって完了する。このレジスト層の剥離は単に第1層の有機高分子材料の溶解処理によって実施することができる。この有機高分子材料は任意のフォトレジストであり、かつ、上記フォトエッティング操作においてなんら変質（硬化等）されていないので、各公知のフォトレジスト自体の有機溶媒を使用することができる。あるいは、プラズマエッティング等の処理により、溶媒を使用することなく剥離することも可能である。

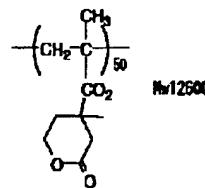
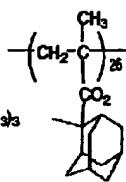
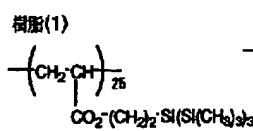
【0157】
20 【実施例】以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるものではない。

【0158】合成例1（樹脂（1）の合成）
トリス（トリメチルシリル）-2-ヒドロキシエチルシリラン29.1gを乾燥THF 200mLに加え、そこへ4-ジメチルアミノビリジン11.2gを添加した。反応液を0℃に冷却した後、そこへアクリル酸クロリド14.0gを1時間かけて滴下した。反応液を室温に戻しながらさらに5時間反応させた。反応液を減圧下濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによりアクリレートモノマーを得た。このアクリレートモノマー-17.3gにメタクリル酸アダマンチルエステル11.1gと、特開平9-90637号に記載の方法で合成したメタクリル酸メバロニックラクトンエステル18.8gをTHF/DMAc(4/1)に溶解させ、固形分35%の溶液を調製した。これを三つ口フラスコに仕込み、窒素気流下60℃に加熱した。反応温度が安定したところで和光純薬（株）製開始剤V-60を1モル%加え反応を開始させた。6時間反応させた後、反応混合物をTHFで2倍に希釈した後、大量のヘキサン中に投入し、白色粉体を析出させた。析出した粉体を沪過取り出し、乾燥して樹脂（1）を得た。得られた樹脂（1）の分子量はGPC測定の結果、ポリスチレンを標準サンプルとして重量平均で12600であった。上記と同様な方法で、樹脂（2）～（7）を得た。上記樹脂（1）～（7）の各繰り返し単位のモル比率と重量平均分子量を以下に示す。

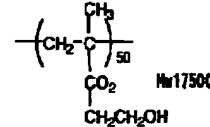
【0159】

【化62】

7.9

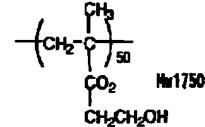
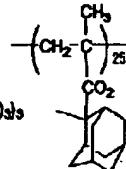
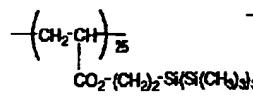


Mw12500



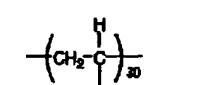
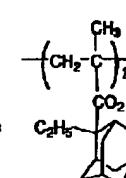
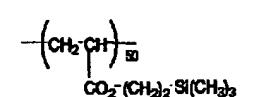
Mw17500

樹脂(2)



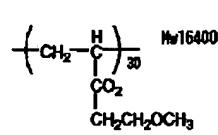
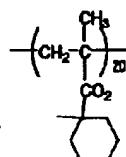
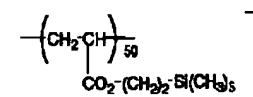
Mw17500

樹脂(3)



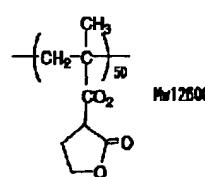
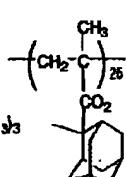
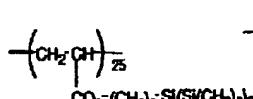
Mw 8500

樹脂(4)



Mw16400

樹脂(5)

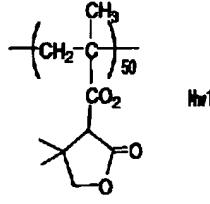
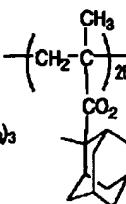
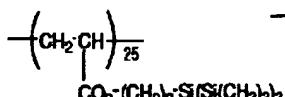


Mw12500

【0160】

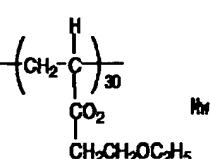
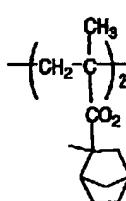
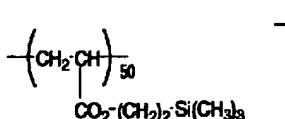
* * 【化63】

樹脂(6)



Mw19400

樹脂(7)



Mw18000

合成例2 (樹脂(8)の合成)

トリス(トリメチルシリル)-2-ヒドロキシエチルシリラン 2.9. 1 g を乾燥 THF 200 ml に加え、そこへ 4-ジメチルアミノピリジン 1.1. 2 g を添加した。反応液を 0°C に冷却した後、そこへアクリル酸クロリド 1.5 g 7.3 g に、特開平9-90637号に記載の方法で合

※4. 0 g を 1 時間かけて滴下した。反応液を室温に戻しながらさらに 5 時間反応させた。反応液を減圧下濃縮した後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーによりアクリレートモノマーを得た。このアクリレートモノマー 1

81

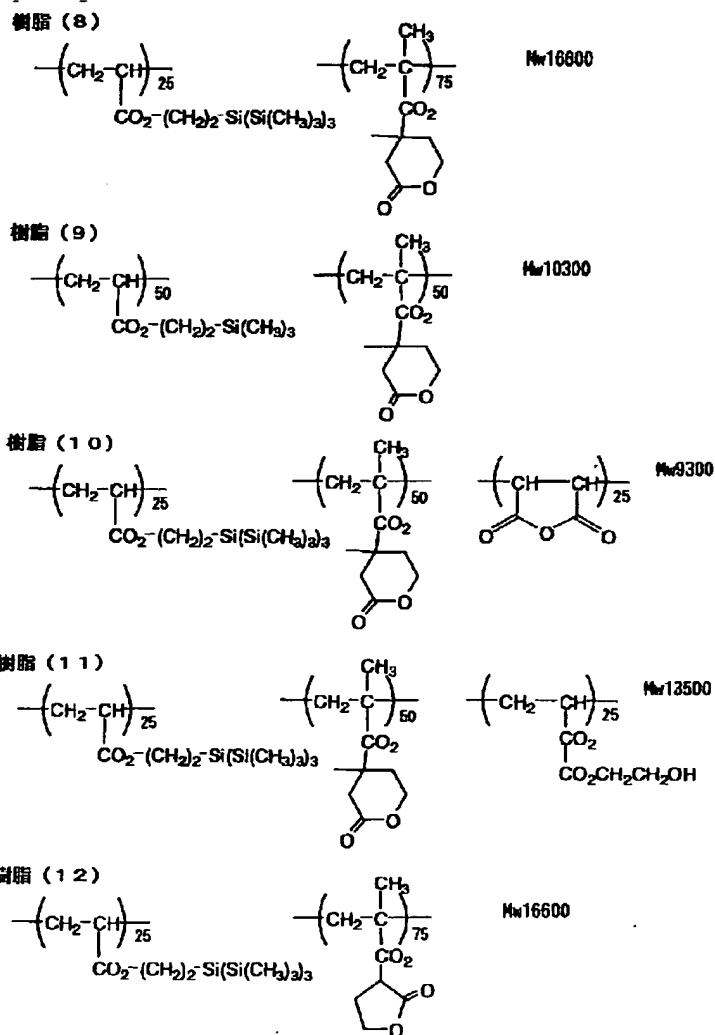
成したメバロニックラクトンメタクリレート29.7gをTHFに溶解させ、固形分40%の溶液を調製した。これを三ツ口フラスコに仕込み、窒素気流下60℃に加熱した。反応温度が安定したところで和光純薬(株)製開始剤V-60を1mol%加え、反応を開始させた。6時間反応させた後、反応混合物をTHFで2倍に希釈した後、大量のヘキサン中に投入し、白色粉体を析出させた。析出した粉体を汎過取り出し、乾燥して樹脂(1)を得た。

*を得た。得られた樹脂(8)の分子量はGPC測定の結果、ポリスチレンを標準サンプルとして重量平均で16600であった。

【0161】上記と同様な方法で樹脂(9)～(14)を得た。上記樹脂(8)～(14)の各繰り返し単位のモル比と重量平均分子量を以下に示す。

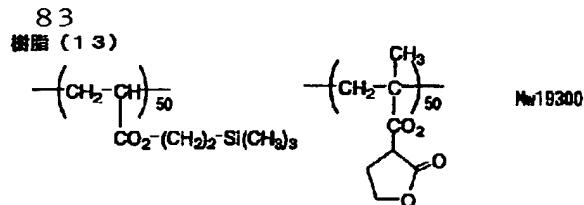
〔0162〕

【化64】

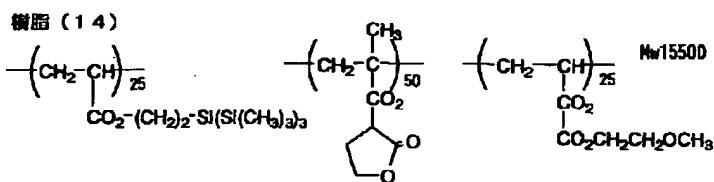


〔0163〕

※40※【化65】



Mw19300



【0164】実施例1～28及び比較例1～6
(ポジ型レジスト組成物の調製と評価) 上記合成例で合成した表1～2に示す樹脂をそれぞれ2g、表1～2に示す光酸発生剤130mg、有機塩基性化合物8mg、界面活性剤10mgを配合し、それぞれ固形分10重量%の割合で表1～2に示す溶剤に溶解した後、0.1μmのミクロフィルターで沪過し、実施例1～28のポジ型レジスト組成物を調製した。また、比較例1～6として、各々上記樹脂と光酸発生剤を用いる以外は、上記実施例1～28と同様にポジ型レジスト組成物を調製した。

【0165】溶剤としては、

S1：プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

S2：プロピレングリコールモノメチルエーテル

【0166】界面活性剤としては、

W-1：メガファックF176（大日本インキ（株）製）（フッ素系）

W-2：メガファックR08（大日本インキ（株）製）（フッ素及びシリコーン系）

W-3：ポリシロキサンポリマーKP-341（信越化学工業（株）製）

W-4：ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

W-5：トロイゾルS-366（トロイケミカル（株）製）

【0167】有機塩基性化合物として、

1：DBU (1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]-7-ウンデセン)

* 2 : 4-DMAP (4-ジメチルアミノピリジン)

3 : TPI (2, 4, 5-トリフェニルイミダゾール) を表す。

【0168】（評価試験）シリコンウエハーにFHi-028Dレジスト（フジフィルムオーリン社製、i線用レジスト）をキャノン製コーティング装置CDS-650を用いて塗布し、90℃、90秒ペークして膜厚0.83μmの均一膜を得た。これをさらに200℃、3分加熱したところ膜厚は0.71μmとなった。この上に上記で調整したレジスト液を塗布、140℃、90秒ペークして0.20μmの膜厚で塗設した。

【0169】こうして得られたウェハーをArFエキシマレーザーステッパーに解像力マスクを装填して露光量と焦点を変化させながら露光した。その後クリーンルーム内で120℃、90秒加熱した後、テトラメチルアンモニウムヒドロオキサイド現像液(2.38%)で60秒間現像し、蒸留水でリーン、乾燥してパターンを得た。このようにして得られたシリコンウエハーのレジストパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、レジストを下記のように評価した。これらの評価結果を表1～2に示す。

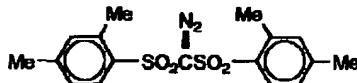
【0170】〔露光マージン〕：0.14μmの孤立ラインのマスク線幅を再現する露光量を±5%変動させたときの得られるパターンの線幅の変動率(%)を露光マージンの指標とした。この値が小さいほど好ましい。

【0171】

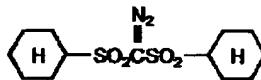
【表1】

実施例	樹脂	光酸発生剤	溶剤	有機塩基性化合物	界面活性剤	露光マージン(%)
1	1	I-3	S1	1	1	6
2	2	I-4	S1	2	2	5
3	3	I-6	S1	3	4	7
4	4	I-7	S1	1	5	5
5	5	I-10	S1	2	3	7
6	6	I-15	S1	8	2	5
7	7	II-1	S1	1	1	7
8	8	II-3	S1	2	2	5
9	9	III-1	S1	3	3	9
10	10	III-3	S1	1	4	5
11	11	III-10	S1	2	5	7
12	12	I-29	S1	3	1	5
13	13	I-28	S1	1	2	7
14	14	I-30/III-3 = 2/1	S1	2	3	6
15	1	I-4	S1/S2 = 9/1	3	1	<5
16	2	I-7/PAG7-1 = 5/1	S1/S2 = 9/1	1	2	5
17	3	I-15	S1/S2 = 9/1	2	3	<5
18	4	I-29/PAG7-2 = 6/1	S1/S2 = 9/1	3	5	5
19	5	I-3	S1/S2 = 9/1	1	1	<5
20	6	II-3	S1/S2 = 9/1	2	2	<5

PAG7-1



PAG7-2



【0172】

* * 【表2】

実施例	樹脂	光酸発生剤	溶剤	有機塩基性化合物	界面活性剤	露光マージン(%)
21	7	III-3/PAG6-17 = 5/1	S1/S2 = 9/1	3	3	5
22	8	I-4	S1/S2 = 9/1	1	5	<5
23	9	I-7/PAG3-18 = 8/1	S1/S2 = 9/1	2	1	5
24	10	I-15/PAG7-2 = 4/1	S1/S2 = 9/1	3	2	5
25	11	I-29	S1/S2 = 9/1	1	3	<5
26	12	I-3/PAG4-5 = 9/1	S1/S2 = 9/1	2	5	5
27	13	II-3	S1/S2 = 9/1	3	1	<5
28	14	III-3	S1/S2 = 9/1	1	2	<5
比較例1	1	PAG3-5	S1	2	3	50
比較例2	2	PAG4-5	S1	なし	なし	100
比較例3	3	PAG7-1	S1	なし	なし	80
比較例4	8	PAG4-5	S1	8	4	45
比較例5	9	PAG6-13	S1	なし	なし	120
比較例6	10	PAG3-5	S1	なし	なし	120

【0173】上記表1、2に示すように、本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、露光マージンにおいて優れた性能を示した。

【0174】

【発明の効果】本発明は、半導体デバイスの製造において露光マージンを改善する。

※て、露光マージン（特に孤立ラインの露光マージン）に対する改善効果がある、すなわち露光量を変化させたときの、孤立ラインの線幅変動が小さいポジ型フォトレジスト組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7	識別記号	F I	テーマコード(参考)
C 08 L 33/04		C 08 L 33/04	
43/04		43/04	
G 03 F 7/004	5 0 3	G 03 F 7/004	5 0 3 A
7/075	5 1 1	7/075	5 1 1
H 01 L 21/027		H 01 L 21/30	5 0 2 R

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA02 AA09 AA10
AB08 AB15 AB16 AB17 AC08
AD03 BE07 BE10 BG00 CC20
FA03 FA12 FA17 FA41
4J002 BG071 BG081 BG091 BQ001
EB116 EV236 EV296 GP03
4J100 AL08P AL08Q AL26P AL26Q
AM10P AM10Q BA02Q BA04Q
BA11Q BA14Q BA15P BA15Q
BA72P BA72Q BA80P BA80Q
BC02Q BC04P BC04Q BC08Q
BC09Q BC12Q BC53Q CA01
CA04 CA05 JA38